



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة التقنية الشمالية كلية البوليتكنيك الموصل



الحقيبة التعليمية



القسم العلمي: تقنيات صناعة الاطراف والمساند
إسم المقرر: دوائر الكترونية متقدمة
المستوى: الثاني
الفصل الدراسي: الثاني
السنة الدراسية: 2026-2027

اسم المقرر:	دوائر الكترونية متقدمة	
القسم:	تقنيات صناعة الأطراف والمساند	
الكلية:	كلية البوليتكنيك الموصل	
المرحلة / المستوى:	الثانية	
الفصل الدراسي:	الثاني	
عدد الساعات الاسبوعية:	نظري: 2	عملي: 3
عدد الوحدات الدراسية:	5	
الرمز:	ETMI207	
نوع المادة:	نظري	عملي
معلومات تدريسي المادة		
اسم مدرس (مدرسي) المقرر:	زيد خلف محمد	
اللقب العلمي:	مدرس مساعد	
سنة الحصول على اللقب:	2023	
هل يتوفر نظير للمقرر في الأقسام الأخرى:	نعم	
اسم المقرر النظير:		
القسم:		
رمز المقرر النظير:		
عدد الساعات الاسبوعية:		
هل يتوفر نظير للمقرر في الأقسام الأخرى:		
اسم المقرر النظير:		
القسم:		
رمز المقرر النظير:		

الوصف العام للمقرر:

دوائر الكترونية هو مقرر مكمل لمادة الالكترونيك حيث يتناول هذا المقرر الدوائر الالكترونية بالتفصيل وكيفية عملها و مجال تطبيقاتها العملية اضافة لتعلم التعامل مع الإشارة الكهربائية والتحليلات النظرية لعملها وأمثلة رياضية . محولة مع بيان استخداماتها العملية التطبيقية في الأجهزة الطبية .

الاهداف العامة :

سيكون الطالب في نهاية المقرر قادرا على ان :

- يتعرف على مكونات الدوائر الالكترونية
- يتعلم استخدامات الدوائر الالكترونية ومجال تطبيقاتها.

الأهداف الخاصة :

سيكون الطالب في نهاية المقرر قادرا على ان :

1. التعرف على مكونات الدائرة الالكترونية.
2. معرفة عمل كل جزء من أجزاء الدائرة الالكترونية .
3. يتتبع الأخطاء التي تحصل في الدائرة الالكترونية.
4. يشارك في تصميم وتجميع الدائرة الالكترونية
5. يضع التصاميم الخاصة بمشروع التخرج.

الأهداف السلوكية او نواتج التعلم

بعد الانتهاء من الدرس (المحاضرة) سيكون الطالب قادرا على ان:

• يتعرف على ماهي مكونات الدوائر الالكترونية.

• يميز بين أجزاء الدائرة الالكترونية .

• يعرف الخلل المحتمل الحدوث في الدائرة الالكترونية

مقرر (الالكترونيك).

الأهداف السلوكية او مخرجات التعليم الأساسية

آلية التقييم	تفصيل الهدف السلوكي او مخرج التعليم	ت
اختبارات شفوية وتحريرية	التعرف على مكونات الدائرة الالكترونية.	1
اختبارات عملية	تمييز أجزاء الدائرة الالكترونية	2
اختبارات شفوية وعملية	تحليل الاعطال المحتملة الحدوث في الدائرة الالكترونية	3
اختبارات تحريرية وعملية	يقيم اداء الدائرة الالكترونية . أساليب التدريس:	4

مبررات الاختيار	الاسلوب او الطريقة
طريقة سهلة وسريعة لايصال المادة لذهن الطالب المتلقي.	1. الشرح النظري للمادة بطريقة عرض PP.
طريقة تفاعلية اثبتت نجاحها في ترسيخ المعلومة في ذهن الطالب	2. مشاركة الطلبة بالنقاش
تزيد من حماس الطلبة لتحقيق نتائج مشرفة بين زملائهم	3. تقسيم الطلبة لمجاميع
تجعل الطالب في تماس مع الدرس وتحفزه لتحضير المحاضرة والانتباه لها واستيعابها بكل طاقته.	4. الاختبارات القبلية والبعدية الشفوية.
طريقة تزيد من تواصل الطلبة مع المادة وتساعد على تقييمهم المستمر	5. الاختبارات اليومية التحريرية
تساعد في التقييم الشامل للطلبة والمادة وكذلك تعكس مدى نجاح الاستاذ	6. الاختبارات الشهرية والنهائية

الفصل الاول

D.C Power Supply						
مجهز القدرة المستمرة/ منظم زنير	الوقت		مجهز القدرة المستمرة			
طرق القياس	التقنيات	طريقة التدريس	العملي	النظري	التوزيع الزمني	
اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	محاضرة	منظم زنير	منظم التوالي Series regulator	الأسبوع الأول	ساعتان
اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	محاضرة		منظم التوازي Parallel regulator	الأسبوع الثاني	ساعتان

الفصل الثاني

OPAMP Applications	OPAMP Applications					
	الوقت					
التوزيع الزمني	النظري	العملي		طريقة التدريس	التقنيات	طرق القياس
الأسبوع الأول	ساعتان	ساعتان	Operational Amplifier (OPAMP)	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الأسبوع الثاني	ساعتان	ساعتان	تطبيقات OPAMP	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الاسبوع الثالث	ساعتان	ساعتان	OPAMP تطبيقات	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات

الفصل الثالث

OPAMP Applications	OPAMP Applications					
	الوقت					
التوزيع الزمني	النظري	العملي		طريقة التدريس	التقنيات	طرق القياس
الأسبوع الأول	ساعتان	ساعتان	Analog Comparator	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الأسبوع الثاني	ساعتان	ساعتان	Differentiator	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الاسبوع الثالث	ساعتان	ساعتان	Intagrator	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات

الفصل الثالث

OPAMP Applications	OPAMP Applications					
	الوقت					
التوزيع الزمني	النظري	العملي		طريقة التدريس	التقنيات	طرق القياس
الأسبوع الأول	ساعتان	ساعتان	.Using OP AMP. In wave Rectification	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الأسبوع الثاني	ساعتان	ساعتان	Analogue Computer	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الاسبوع الثالث	ساعتان	ساعتان	حل امثلة Analogue Computer	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات

الفصل الرابع

Multivibrators

Multivibrators	الوقت					
التوزيع الزمني	النظري	العملي		طريقة التدريس	التقنيات	طرق القياس
الأسبوع الأول	ساعتان	ساعتان	Astable Multivibrators (A.M)	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الأسبوع الثاني	ساعتان	ساعتان	Monostable Multi (M.M)	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات
الاسبوع الثالث	ساعتان	ساعتان	Bistable Multi (B.M)	محاضرة	عرض تقديمي، شرح، حل امثلة، أسئلة وأجوبة، مناقشة	اختبارات شفوية وتحريرية وإعطاء واجبات

المصادر:

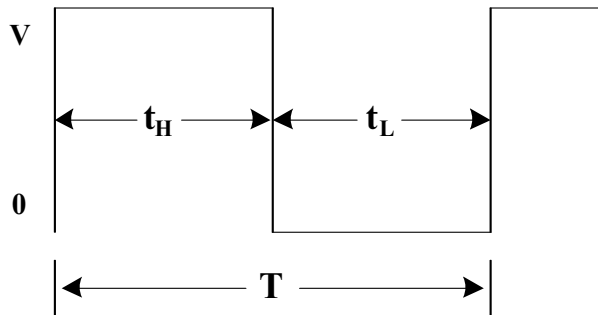
1. Operational Amplifiers & Linear Integrated Circuits: Theory and Application by James M. Fiore, 2021.
2. SUV. الكترونيات تأليف د. محمد سويدان 2018.

Duty Cycle

دورة التشغيل

تعرف دورة التشغيل على أنها النسبة بين زمن الموجة في المستوى العالي وزمن الموجة الكلي ورمزها D، وتكون قيم D عادة :
 $0\% < D < 100\%$

$$D\% = \frac{t_H}{t_H + t_L} * 100\%$$



حيث أن:

t_H زمن النبضة في المستوى العالي.
 t_L زمن النبضة في المستوى الواطئ.

$$T = t_H + t_L$$

$$f = \frac{1}{T}$$

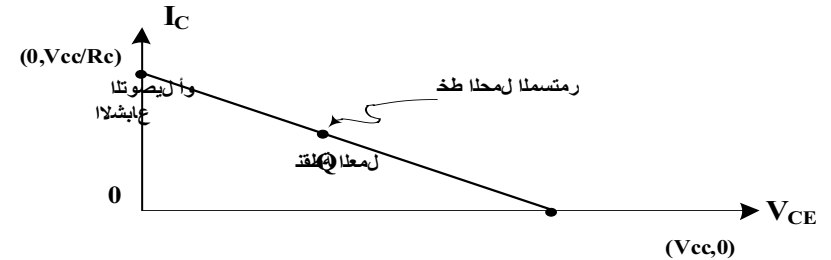
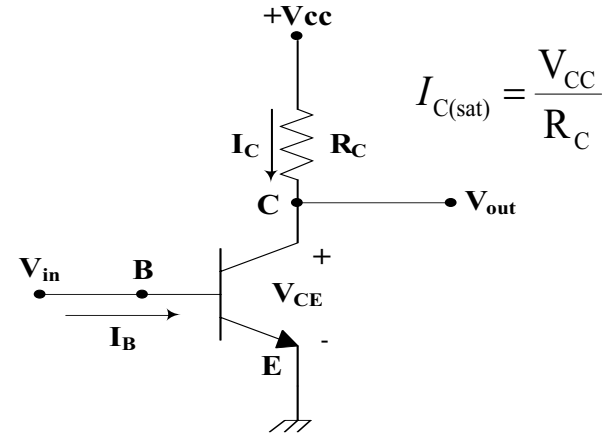
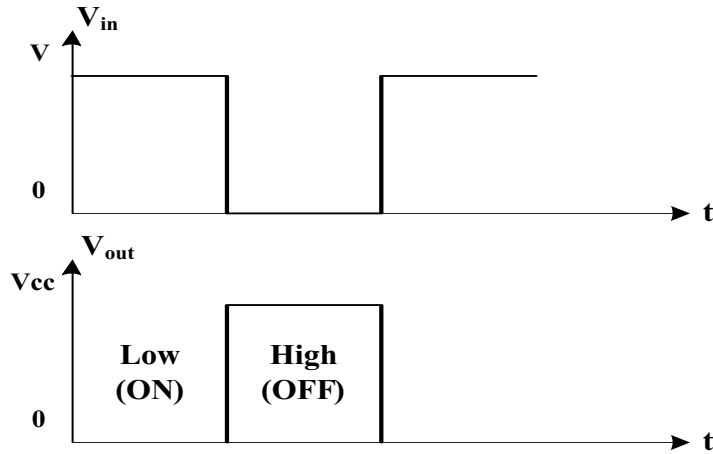
إذا كانت $t_H = t_L$ فإن $D\% = 50\%$.

Transistor as Switch

الترانزستور كمفتاح

هي عبارة عن دائرة ترانزستور مربوطة بصيغة الباعث المشترك يكون الترانزستور في حالة توصيل (ON) ($V_{CE}=0$) إذا كانت الفولتية على القاعدة كافية لإمرار تيار قاعدة يجعل تيار الجامع في حالة إشباع

ويكون في حالة قطع (OFF) ($V_{CE}=V_{CC}$) عندما يكون جهد القاعدة قليل أو صفر. وكما مبين أدناه الدائرة وموجة نبضات الإدخال والإخراج وخط الحمل.



Multivibrators

المهتزازات

وتسمى أيضاً المهزازات أو متعددات التوافقيات، وهي أحد أنواع دوائر مولدات الإشارة النبضية التي تستخدم مرحلتي تكبير، ويستخدم فيها الترانزستور كمفتاح. وتتضمن عادة ترانزستورين وتكون التغذية العكسية المتبادلة هي المسؤولة عن السيطرة على تبادل حالة الترانزستورين بين التوصيل والقطع. تستعمل المهتزازات في المنظومات الرقمية وغيرها، وبإمكانها توليد نبضات بمدى واسع من الترددات 20Hz إلى 30MHz.

أنواع المهتزازات

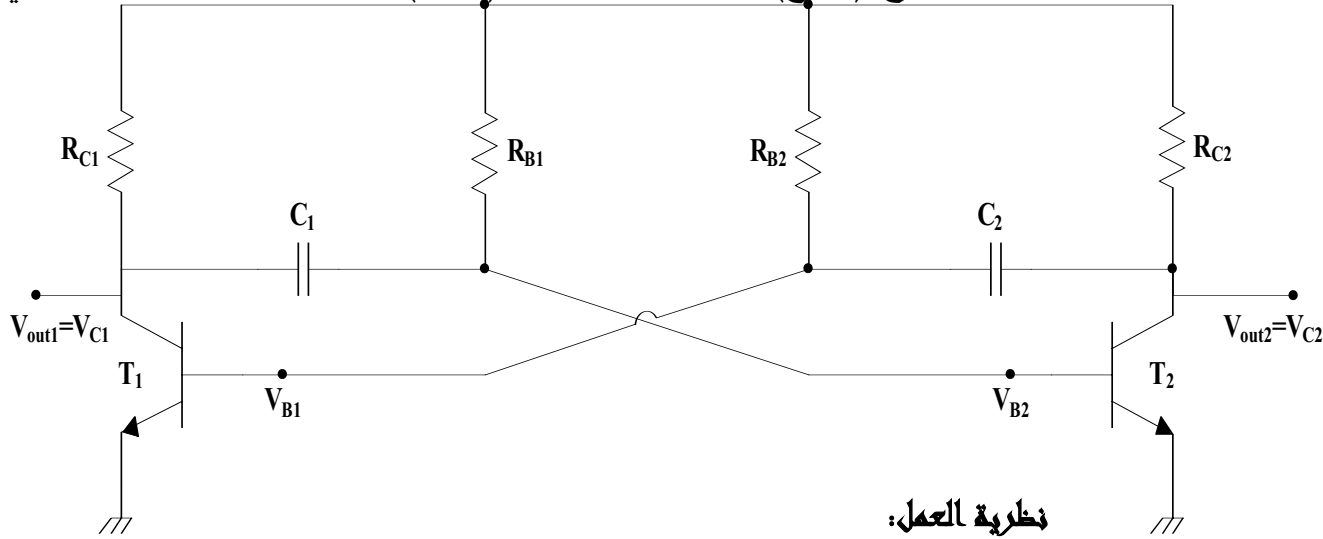
استناداً إلى حالة الاستقرار في نبضة الإخراج يمكن تقسيم المهتزازات إلى ثلاثة أنواع هي:

- Astable Multivibrators (A.M). المهتزازات الغير المستقرة
- Monostable Multivibrators (M.M) . المهتزازات احادية الاستقرار
- Bistable Multivibrators (B.M). المهتزازات ثنائية الاستقرار

Astable Multivibrators (A.M)

المهتز غير المستقر

ويسمى أيضاً اللامستقر أو عديم الاستقرار أو حر الدوران (Free tuning) أو مولد النبضات (Pulse generator). يستخدم المهتز غير المستقر لتوليد النبضات ولا يحتاج نبضات إدخال لأنه غير مستقر في حالتي التوصيل والقطع : ويربط إخراج (جامع) كل مرحلة كإدخال (قاعدة) للمرحلة الأخرى كما مبين في الشكل التالي



نظرية العمل:

(دائرة المهتز غير المستقر)

له حالتين غير مستقرة:

الأولى: T_1 توصيل T_2 قطع.

الثانية: T_1 قطع T_2 توصيل.

يحاول كلا الترانزستورين التوصيل في لحظة تجهيز القدرة المستمرة إلى الدائرة، ويتحول أحدهما إلى حالة الإشباع عندما تكون

وبما أننا نعلم تعذر إمكانية وجود ترانزستورين متماثلين بالخواص تماماً، مما ينتج عنه توصيل أحدهما قبل الآخر، ($R_B < h_{FE} \cdot R_C$)

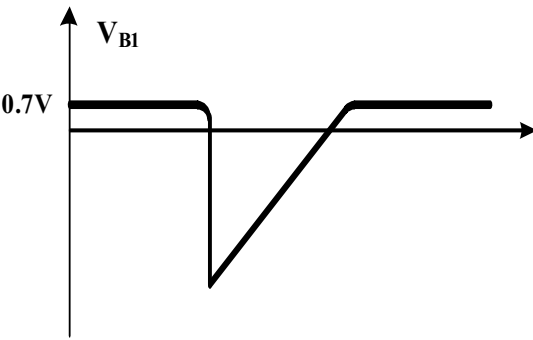
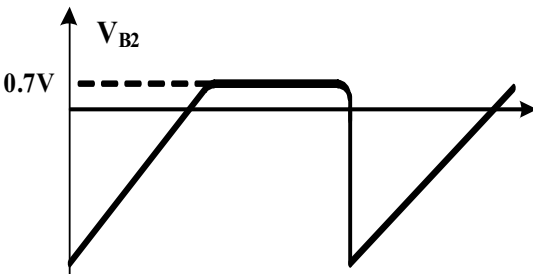
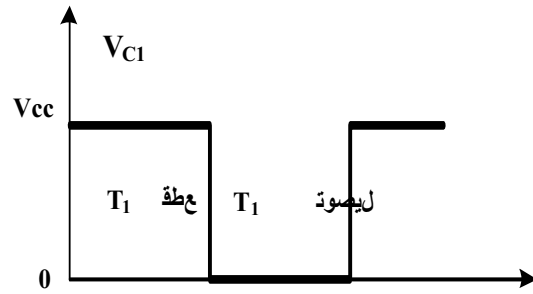
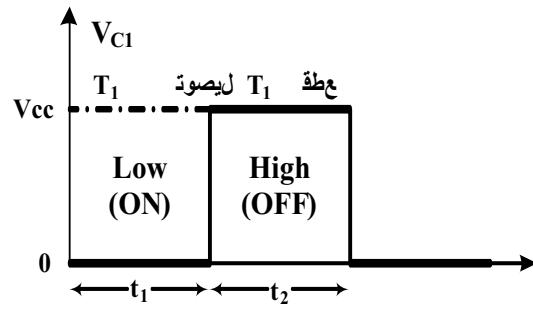
ولو فرضنا أن T_1 يوصل قبل T_2 ، فهذا يعني أن T_1 في حالة توصيل و T_2 في حالة قطع، وفي هذه الحالة تشحن المتسعة C_1 عن

طريق المقاومة R_{B1} وخلال جامع T_1 إلى الأرضي، وبعد فترة زمنية ($t_1 = 0.7 R_{B1} C_1$) سيصل جهد المتسعة C_1 المسلط على قاعدة

T_2 بانحياز أمامي إلى قيمة كافية لتحويل T_2 من حالة القطع إلى حالة التوصيل. وبعد توصيل T_2 يرتبط جامعها بالأرضي فيهبط جهده

الذي يغذي قاعدة T_1 وبذلك يتحول T_1 من حالة التوصيل إلى القطع، وبهذا يكتمل الانتقال من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية من

الحالتين غير المستقرة.



الآن ستنشحن المتسعة C_2 عن طريق المقاومة R_{B2} ومن خلال جامع T_2 إلى الأرضي وبعد فترة زمنية ($t_2=0.7R_{B2}C_2$) يتحول T_1 إلى حالة التوصيل و T_2 إلى حالة القطع وبنفس الحالة الأولى وذلك لهبوط جامع T_1 إلى الصفر. وبذلك نرجع إلى الحالة الأولى. ويتكرر التذبذب طالما كانت الدائرة مبربطة إلى المصدر وسيكون تردد التذبذب f :

$$f = \frac{1}{t_1 + t_2} = \frac{1}{0.7R_{B1}C_1 + 0.7R_{B2}C_2} = \frac{1}{0.7(R_{B1}C_1 + R_{B2}C_2)}$$

$$t_1 = t_{L1} = t_{H2} \quad t_2 = t_{H1} = t_{L2}$$

وإذا كانت $C_1=C_2=C$ و $R_{B1}=R_{B2}=R_B$ فإن التردد يكون:

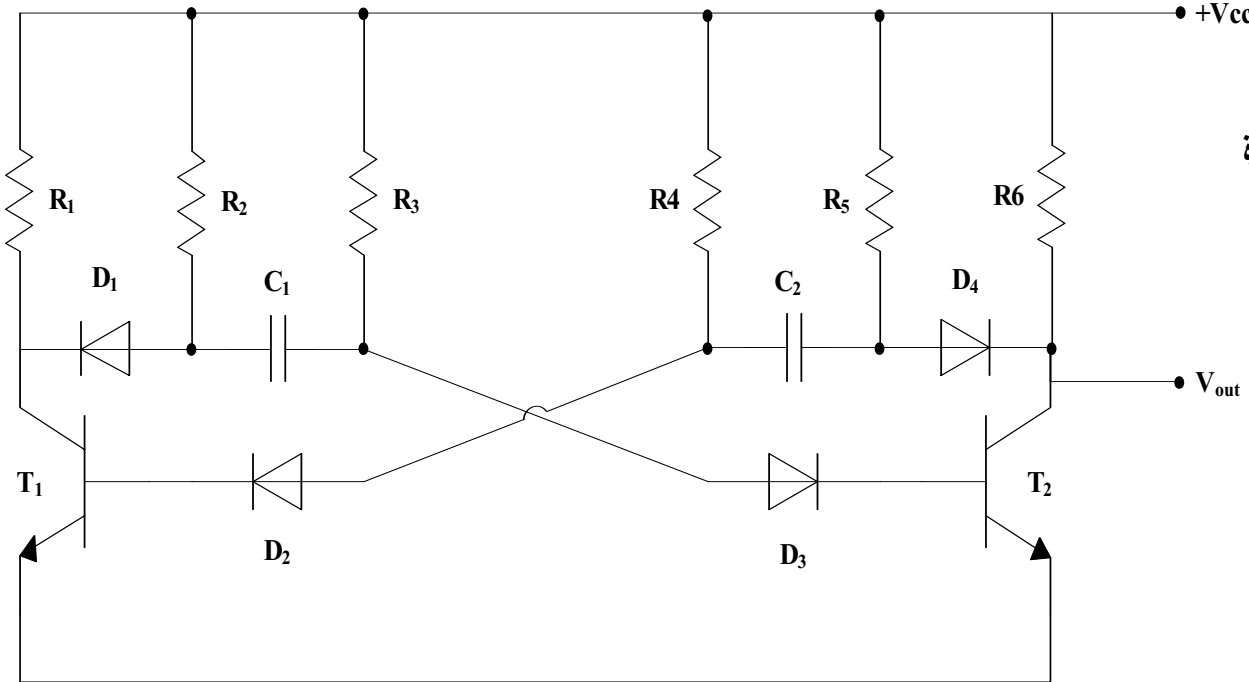
$$f = \frac{1}{1.4R_B C}$$

وعندها تكون موجة نبضية متماثلة أي أن $t_1=t_2$ مما يجعل دورة التشغيل $D\%=50\%$.

(أشكال الموجات للمهتز غير المستقر)

دائرة عملية لمهتز غير مستقر

لحماية الدائرة من ذلك الاحتمال يربط الثنائين (D_3, D_2) المبيينين بالشكل أدناه الذي يمثل الدائرة العملية لهذا المذبذب، ويشترط ان تكون قيمة جهد انهيار هذين الثنائين مساوية إلى أو أكبر من (V_{cc}). يتسبب هذان الثنائيان بإحداث هبوط بقيمة الجهد عند الانحياز الأمامي ، إلا أنهما يوفران الحماية لوصلة القاعدة – الباعث عند الانحياز العكسي. أما الثنائيان (D_4, D_1) والمقاومتان (R_5, R_2) فإنها تسبب إسراعاً بنشوء وارتفاع قيمة نبضة الإخراج. وفي حالة التوصيل لكل ترانزستور يكون الحمل مساوياً للمقاومة المكافئة لربط التوازي لكل من: (R_2, R_1) للترانزستور الأول (T_1). (R_6, R_5) للترانزستور الثاني (T_2).



نفس العلاقات الرياضية للدائرة السابقة مع الأخذ بنظر الاعتبار ،
 $R_3 = R_{B1}$ ، $R_4 = R_{B2}$
 $RC1 = R1 \parallel R2$
 $RC2 = R5 \parallel R6$

مثال: في دائرة مهتز غير مستقر إذا كانت $R_{C1}=R_{C2}=1K\Omega$ و $R_{B1}=R_{B2}=10K\Omega$ و $V_{CC}=12V$ ، $C_1=C_2=0.01\mu F$.
ارسم الدائرة ثم أوجد:

2- أصغر قيمة لـ h_{FE} .

1- تردد التذبذب.

3- دورة التشغيل ثم ارسم موجات الإخراج.

الحل: نرسم الدائرة ونثبت القيم عليها.

$$t_1 = 0.7R_{B1}C_1 = t_{L1} = t_{H2}$$

$$t_2 = 0.7R_{B2}C_2 = t_{H1} = t_{L2}$$

$$T = t_1 + t_2$$

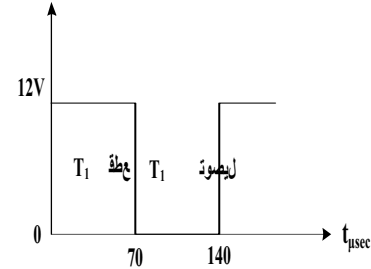
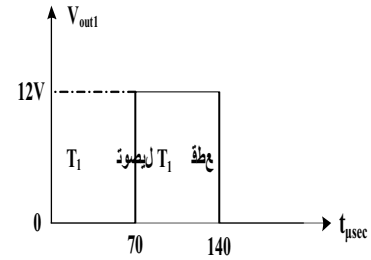
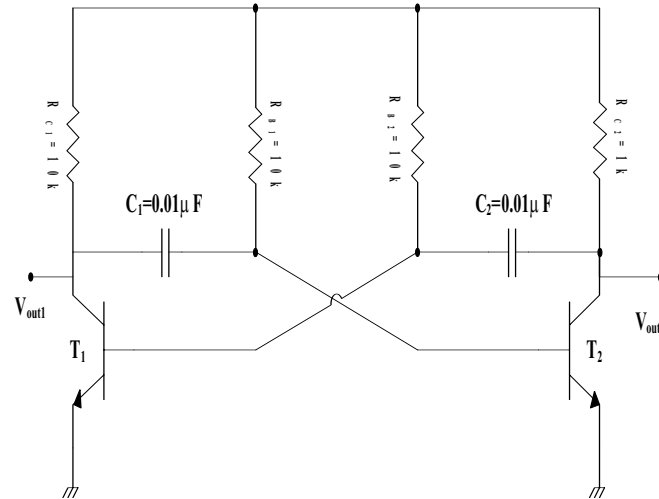
وبما أن الدائرة متساوية القيم فإن:

$$t_1 = t_2 = 0.7R_B C$$

$$= 0.7 * 10 * 10^3 * 0.01 * 10^{-6} = 70msec$$

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{تردد التذبذب}$$

$$= \frac{1}{(70 + 70) * 10^{-6}} = 7142.85 \text{ Hz} = 7.143 \text{ kHz}$$



$$h_{FE} = \frac{R_B}{R_C} = \frac{10k}{1k} = 10 \quad \text{أصغر قيمة لـ } h_{FE} \text{ هي}$$

$$\%D = \frac{t_H}{T} * 100\% = \frac{70msec}{140msec} * 100\% = 50\%$$

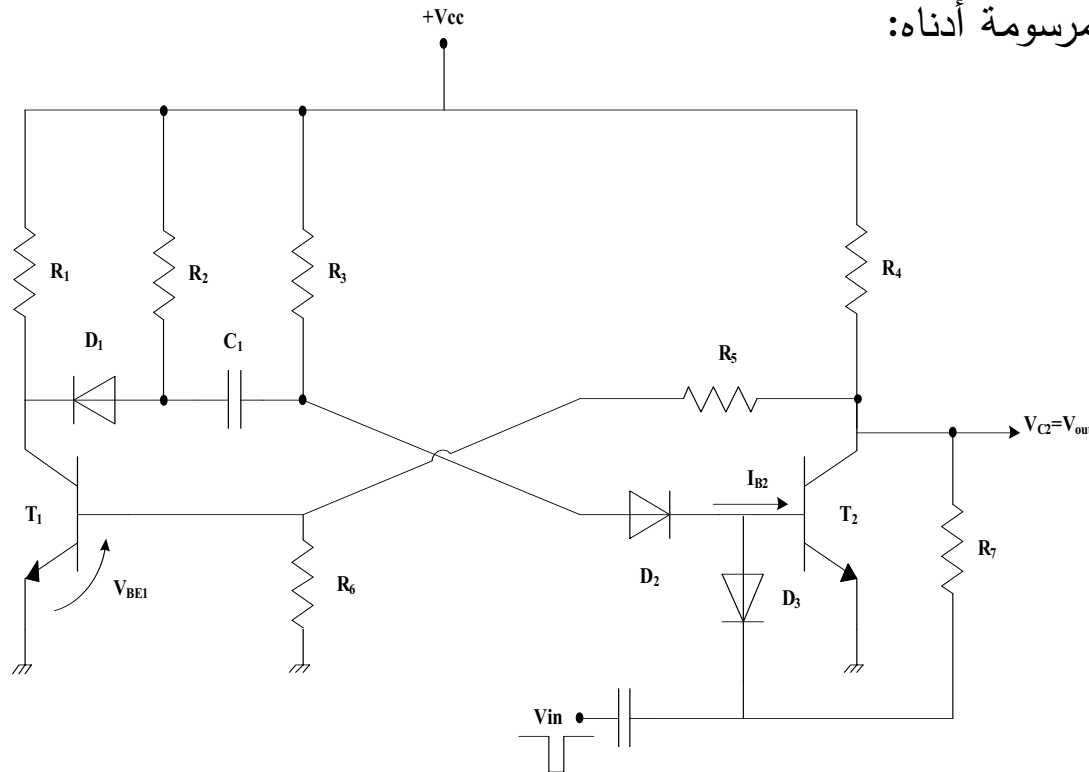
دورة التشغيل

Monostable Multi (M.M)

المهتز أحادي الاستقرار

ويسمى أيضاً مولد الطلقة الواحدة أو مولد الاطلاقة الواحدة أو مولد النبضة الواحدة أو مكبر زمن لأنه يقوم بتوليد نبضة إخراج ذو عرض أكبر من عرض نبضة الإدخال.

له حالتان الأولى مستقرة والأخرى غير مستقرة ويحتاج إلى نبضة قذح لتحويله من الحالة المستقرة إلى الحالة غير المستقرة أما عملية رجوعه إلى الوضع المستقر ثانية فتتكفل بها ثوابت الدائرة بنفس مبدأ المهتز غير المستقر. تتكون دائرة المهتز أحادي الاستقرار من نصف دائرة مهتز غير مستقر ونصف دائرة مهتز ثنائي الاستقرار، كما مبين في الدائرة المرسومة أدناه:



(دائرة المهتز أحادي الاستقرار)

نظرية العمل لمهتز أحادي الاستقرار :

في حالة الوضع المستقر (T_1 قطع و T_2 توصيل) يكون الترانزستور T_2 في حالة توصيل وذلك بسبب التيار المار بقاعدته (I_{B2}) المجهد من المصدر المستمر من خلال المقاومة R_3 والثنائي D_2 (الذي يكون في حالة انحياز أمامي دائماً)، أما الترانزستور T_1 فيكون في حالة قطع وذلك لأن قيمة الجهد V_{BE1} قليلة تقارب جهد الأرضي لأنه جزء من التغذية الخلفية الناتج من جامع T_2 المؤرض لأن T_2 في حالة توصيل.

الحالة المستقرة لهذه الدائرة لا تتغير إلا بعد تسليط نبضة قرح سالبة (بواسطة مصدر خارجي V_{in}) تقوم بإجبار T_2 على التحول من التوصيل إلى القطع، عند ذلك يقوم مقسم الجهد (R_4, R_5, R_6) بتوفير جهد الانحياز الأمامي V_{BE1} اللازم لتحويل T_1 من القطع إلى التوصيل وهذه الحالة غير مستقرة (T_1 توصيل و T_2 قطع) لأن بقاء T_1 في حالة توصيل بسبب شحنة المتسعة C_1 عن طريق المقاومة R_3 خلال الثنائي D_1 وإلى الأرضي عبر جامع T_1 كما هو الحال في المهتز غير المستقر وتستمر لفترة: $t_2 = 0.7R_3C_1$.

وخلال هذه الفترة الزمنية يبلغ الجهد على طرفي المتسعة C_1 قيمة كافية لجعل V_{BE2} بانحياز أمامي يحول T_2 من القطع إلى التوصيل ويقوم جهده المورس بإجبار T_1 على التحول من حالة التوصيل إلى القطع والآن رجعنا إلى الحالة المستقرة التي تبقى لحين وصول نبضة قرح جديدة وهكذا.

عند تسليط نبضة قرح سالبة على المتسعة C_2 ، وأثناء استقرار T_2 على وضع التوصيل يكون D_3 مهياً للتوصيل فتقوم النبضة السالبة بجعل انحيازه أمامياً لأن جهد المهبط له أصبح سالباً ويقوم بالتوصيل مما يسبب قطع التيار المار بقاعدة T_2 وهو التيار I_{B2} وبذلك يتحول T_2 من التوصيل إلى القطع. أن C_2, D_3, R_7 تعمل كدائرة مفاضل (أي ليس فيه تكبير كالذي مر بنا).

مثال: لدائرة مهتز احادي الاستقرار إذا كانت $R_3=8.6k\Omega$ و $V_{cc}=10V$ و $C_1=0.1\mu F$ وإشارة الإدخال مربعة $2V_{pp}$ وبتردد $4kHz$. أحسب تردد الإخراج وارسم موجة الإخراج نسبة إلى موجة الإدخال.

$$T_{in} = \frac{1}{f_{in}} = \frac{1}{4 * 10^3} = 0.25 \text{ msec} \quad \& \quad T_{in} / 2 = 0.25 / 2 = 0.125 \text{ msec}$$

عرض نبضة الإدخال

الحل:

عرض نبضة الإخراج التقريبية =

$$t_2 = 0.7R_3C_1 = 0.7 * 8.6 * 10^3 * 0.1 * 10^{-6} = 0.6 \text{ msec} = T_{out}$$

$$F_{out} \cong \frac{1}{t_2} = \frac{1}{0.6 * 10^{-3}} = 1.667 \text{ KHz}$$

التقريبي

$$\frac{t_2}{T_{in}} = \frac{0.6}{0.25} = 2.4 \rightarrow 3$$

وهي عدد نبضات القذح أثناء T_{out}

$$\therefore T_{out} = 3 * T_{in} = 3 * 0.25 = 0.75 \text{ msec}$$

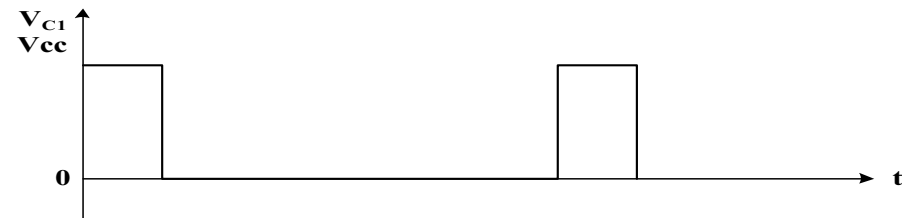
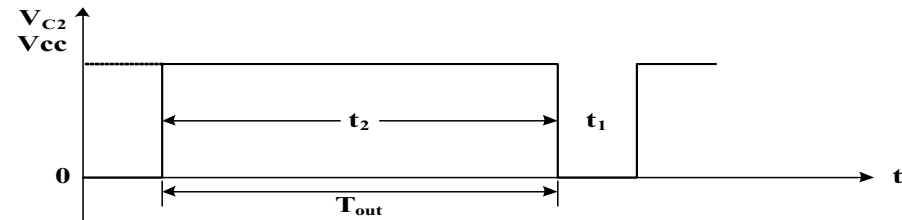
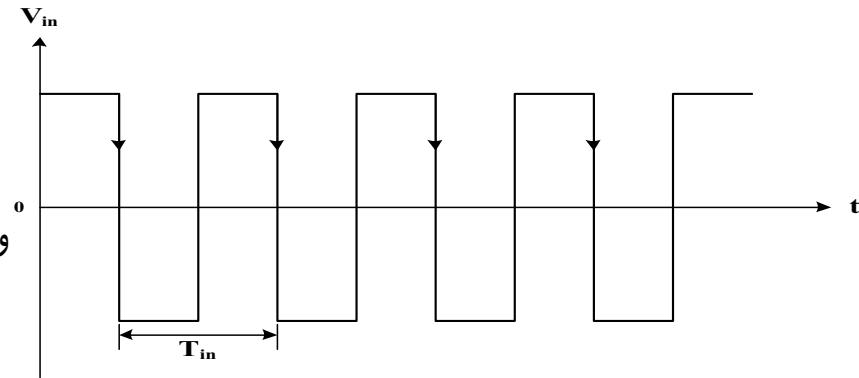
$$f_{out} = \frac{1}{T_{out}} = \frac{1}{0.75 * 10^{-3}} = 1.334 \text{ KHz}$$

المضبوط

$$t_1 = T_{out} - t_2$$

$$= 0.75 - 0.6 = 0.15 \text{ msec}$$

(أشكال موجات المهتز أحادي الاستقرار وبنفس الوقت للمثال اعلاه)



Bistable Multi (B.M)

المهتز ثنائي الاستقرار

وتسمى هذه الدائرة المرجاح (النطاط) Flip-Flop. ويكون لها حالتين مستقرتين:

حالة الاستقرار الأولى: T_1 توصيل، T_2 قطع.

حالة الاستقرار الثانية: T_1 قطع، T_2 توصيل.

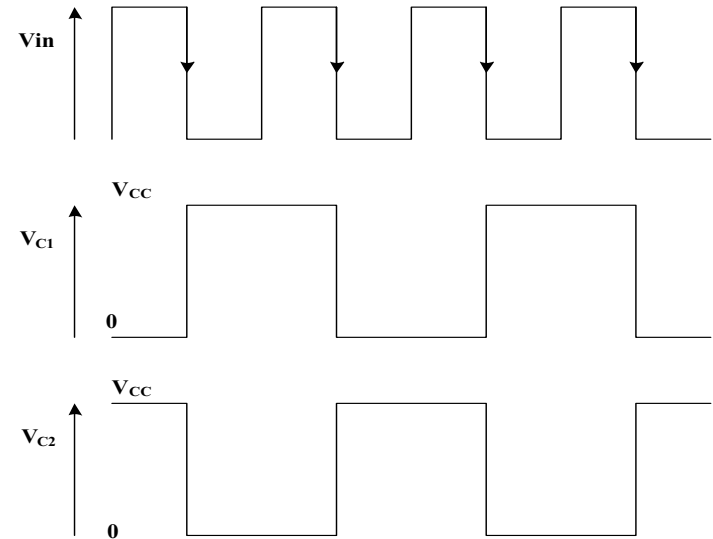
تقوم نبضات القدح بتغيير حالة الاستقرار من الأولى إلى الثانية وبالعكس عن طريق تحويل الترانزستور الذي يكون في حالة

توصيل إلى قطع ومن ثم تقوم حالة القطع بتحويل الترانزستور الآخر إلى توصيل.

يكون تردد الإخراج نصف تردد الإدخال أي:

$$f_{out} = \frac{1}{2} f_{in}$$

تكون الدائرة متناظرة كما مبين في الشكل المبين في الصفحة اللاحقة. وأشكال الموجات كما مبين أدناه:



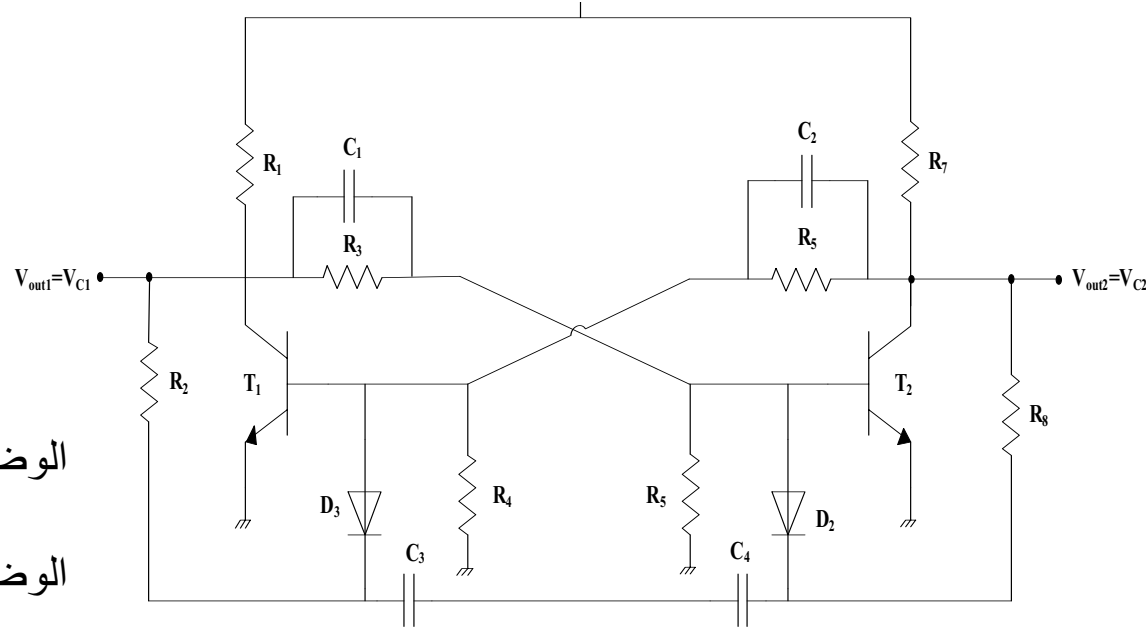
ملاحظة: لتفاصيل أكثر حول المهتز ثنائي الاستقرار راجع كتاب

الدوائر الالكترونية ص 137-138

(دائرة المهتز ثنائي الاستقرار)

الوضع الأول: T1 موصل و T2 مقطوع

الوضع الثاني: T1 مقطوع و T2 موصل



* المتسعتان C_1 ، C_2 فائدتهما تسريع زمن التحويل ويكونان ذو قيم قليلة.

أن نبضات القدح ضرورية جداً لتسوق دائرة هذا المهتز، حيث تكون مسؤولة عن تحويل الدائرة من وضع مستقر إلى الوضع الآخر. أما كيفية الحصول على نبضات القدح (Trigger Pulses) فتكون عادة من مولد موجة مربعة (Square Wave Generator) بعد إمراره على دائرتي تفاضل تتكون الأولى من (R_8 , D_2 , C_4) للترانزستور (T_2) وتتكون الثانية من (R_2 , D_1 , C_3) للترانزستور (T_1). تكون نبضة القدح المغيرة للوضع المستقر مشتركة لكلا الترانزستورين. إلا أنها تسوق الترانزستور الموصل فقط، ولا تؤثر على الآخر لأنه من الأصل في حالة قطع.

أهمية المقاومتين (R_8) و (R_2)

يتلخص عمل المقاومتين (R_2) و (R_8) بما يلي:

من خلال الترانزستور المشبع (D_1) بتأريض مهبط الثنائي (R_2) مقطوع، تقوم المقاومة (T_2) موصل و (T_1) أولاً: عند وضع الاستقرار الأول وبهذا يكون (T_2) المرتفعة الجهد (بسبب قطع (T_2) إلى نقطة جامع الترانزستور (D_2) فإنها توصل مهبط الثنائي (R_8) أما المقاومة (T_1) فإن انحيازه عكسي ويبقى عند القطع حتى تسليط نبضة القدح المسوقة لترانزستوري الدائرة (D_2) مهبطاً للتوصيل، أما الثنائي (D_1) الثنائي

جدول مقارنة بين أنواع المهتزازات

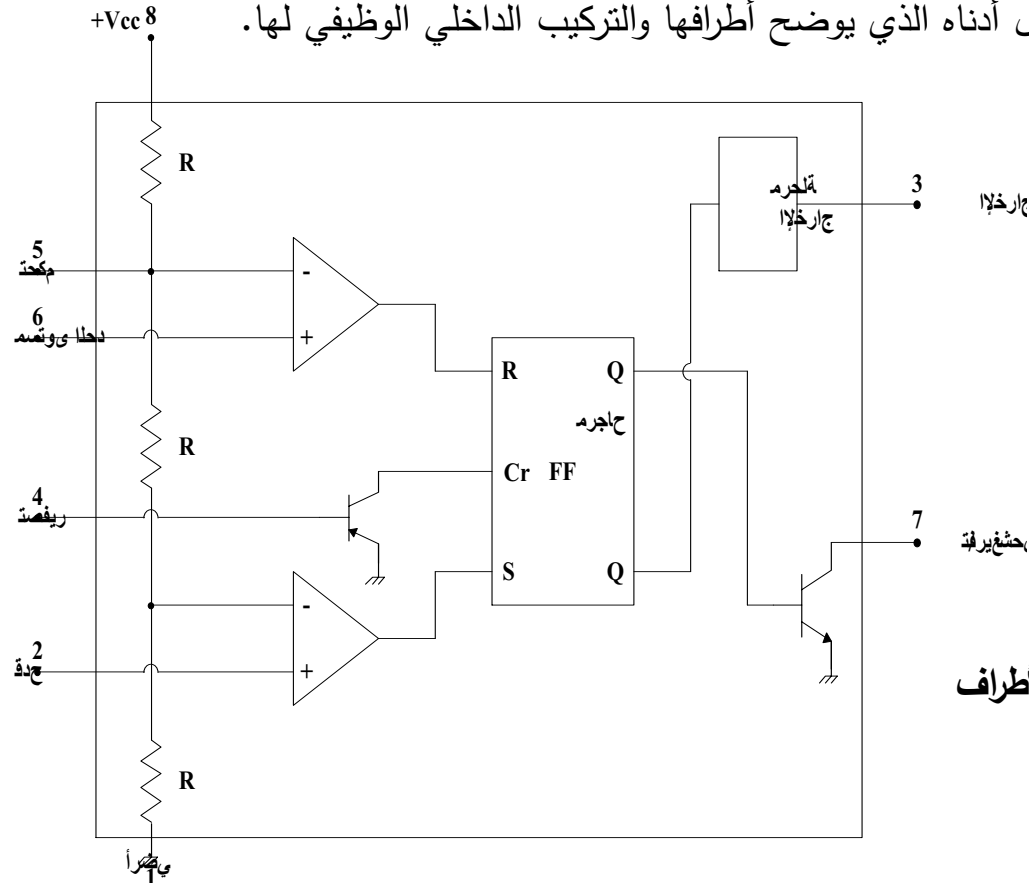
المهتز ثنائي الاستقرار (B.M.)	المهتز احادي الاستقرار (M.M.)	المهتز الغير مستقر (A.M.)
1. أحد دوائر توليد النبضات.	1. أحد دوائر توليد النبضات.	1. أحد دوائر توليد النبضات.
2. يتألف من مرحلتين كل منهما ترانزستور كمفتاح.	2. يتألف من مرحلتين كل منهما ترانزستور كمفتاح.	2. يتألف من مرحلتين كل منهما ترانزستور كمفتاح.
3. حالتي الدائرة مستقرة.	3. حالتي الدائرة : إحداهما مستقرة والأخرى : غير مستقرة.	3. حالتي الدائرة غير مستقرة.
4. يحتاج لنبضات قرح للحالتين المستقرتين.	4. يحتاج لنبضات قرح في الحالة المستقرة.	4. لا يحتاج لنبضات قرح.
5. تردد الإخراج هو نصف تردد الإدخال. $4R_B C_1$	5. تردد الإخراج $f = \frac{1}{0.7R_3 C_1}$ حيث $0.7R_3 C_1$ هي عرض نبضة الإخراج.	5. تردد الإخراج إذا كانت $R_{B1}=R_{B2}=R_B$ و $f_{out} = \frac{f_{in}}{2}$ $C_1=C_2=C$
6. يستخدم كمقسم تردد.	6. يستخدم للحصول على نبضة إخراج ذو عرض أكبر من عرض نبضة القرح.	6. يستخدم لتوليد نبضات مدى واسع من الترددات. 20 Hz – 30 MHz
7. دائرته هي كما في الرسم أدناه:	7. دائرته هي كما في الرسم أدناه:	7. دائرته هي كما في الرسم أدناه:
8. نظرية العمل له ...	8. نظرية العمل له ...	8. نظرية العمل له ...

Integrated Circuit

555 555

الدائرة المتكاملة

- هي دائرة متكاملة تناظرية (خطية) وهي مناسبة للعمل مع الدوائر الرقمية أيضاً، ولها مزايا عديدة منها:
- صغر الحجم وخفة الوزن ورخص ثمنها وسهولة التعامل معها.
 - المدى الواسع من الجهد الذي تعمل به (4 إلى 16 فولت).
 - قابليتها للعمل مع الدوائر الرقمية.
- ولها ثمانية أطراف كما مبين في الشكل أدناه الذي يوضح أطرافها والتركيب الداخلي الوظيفي لها.



(التركيب الداخلي الوظيفي والأطراف
للدائرة المتكاملة 555)

أطراف الدائرة المتكاملة 555

الطرف 1: أرضي (Ground) يعمل هذا الطرف أرضياً للدائرة ويربط مع القطب السالب لجهد التجهيز.

الطرف 2: القدح (Trigger) وهو طرف إدخال لتغيير حالة الإخراج من واطيء LOW إلى عال High وذلك عندما يقل جهد هذا الطرف عن

$\frac{1}{3} V_{cc}$ حيث يسبب المقارن 2 تغيير حالة المرجاح والذي بدوره يغير حالة مرحلة الإخراج من واطيء إلى عال. ويجب ان يكون

عرض نبضة القدح أقل من حاصل ضرب RC (المقاومة والتمتعة الخارجيتين).

الطرف 3: الإخراج (output) وهو طرف إخراج الدائرة ويكون جهده ($V_{out}=V_{cc}-1.7$) وله القابلية على تجهيز تيار حمل يصل إلى 200mA.

الطرف 4: التصفير (Reset) يستعمل هذا الطرف لتصفير الإخراج عندما يكون جهده بين صفر و 0.4V حيث يقوم بتصفير المرجاح الذي

يسيطر على مرحلة الإخراج. ولمنع التصفير الغير مرغوب فيه يربط هذا الطرف إلى القطب الموجب لجهد التجهيز في حالة عدم الاستعمال وعند استخدامه يربط إلى مفتاح Switch يقوم بالسيطرة على اشتغال الدائرة.

الطرف 5: جهد التحكم (Control Voltage) يستخدم هذا الطرف للتحكم في تردد نبضات الإخراج وذلك من دون الاعتماد على قيمة RC، وذلك بتغيير جهد الإدخال المسلط على هذا الطرف بمدى محدد من 45% إلى 90% من جهد التجهيز V_{cc} في صيغة أحادي الاستقرار، بينما يكون المدى أوسع من 1.7V إلى V_{cc} في صيغة المهتز غير المستقر حيث تكون موجة الإخراج بشكل تضمين ترددي FM وفي حالة عدم استعمال هذا الطرف يفضل توصيله إلى الأرضي عبر متسعة صغيرة ($0.01\mu F$) للحفاظ على المناعة ضد الضوضاء.

الطرف 6: مستوى حد الجهد (Threshold Voltage) أو مستوى الحد يمثل هذا الطرف أحد إدخال المقارن، فعندما يتغذى جهد الإدخال Low المسلط على هذا الطرف ، فإن إخراج المقارن يتسبب في تصفير المرحاح الذي بدوره يجعل مرحلة الإخراج في حالة شرط أن لا يقل تيار الإدخال لهذا الطرف عن $0.1\mu A$ (باختصار يقوم هذا الطرف بتغيير حالة جهد الإخراج من عالي إلى واطئ عندما يكون جهده أكبر من $\frac{2}{3}V_{cc}$)

الطرف 7: شحن / تفريغ (Charge / Discharge) يعمل هذا كدائرة قصر (short) عندما يكون الإخراج في حالة واطئ

مما يساعد على تفريغ شحنة متسعة التوقيت C (المربوطة خارجياً بين هذا الطرف والأرضي). أما عندما يكون الإخراج في حالة عال فإن الطرف يتصرف بشكل دائرة مفتوحة (Open) مما يسمح للمتسعة بالشحن ولزمن يعتمد على قيمة كل من C و R. إن مبدأ شحن المتسعة وتفريغها هو أساس فكرة التوقيت في هذه الدائرة المتكاملة 555.

الطرف 8: تجهيز القدرة (Vcc (Power Supply) يربط هذا الطرف بالقطب الموجب لمجهز القدرة الذي يتراوح بين 4 إلى 16 فولت وفي بعض الأنواع للمؤقت 555 يتراوح بين 3 إلى 18 فولت.

ملاحظة: أن اقل قيمة لمقاومة الحمل يمكن ربطها على إخراج الدائرة المتكاملة 555 وهو الطرف 3 يحددها أعظم تيار تجهزه الدائرة وقدره $200mA$ ويمكن حسابها من العلاقة التالية:

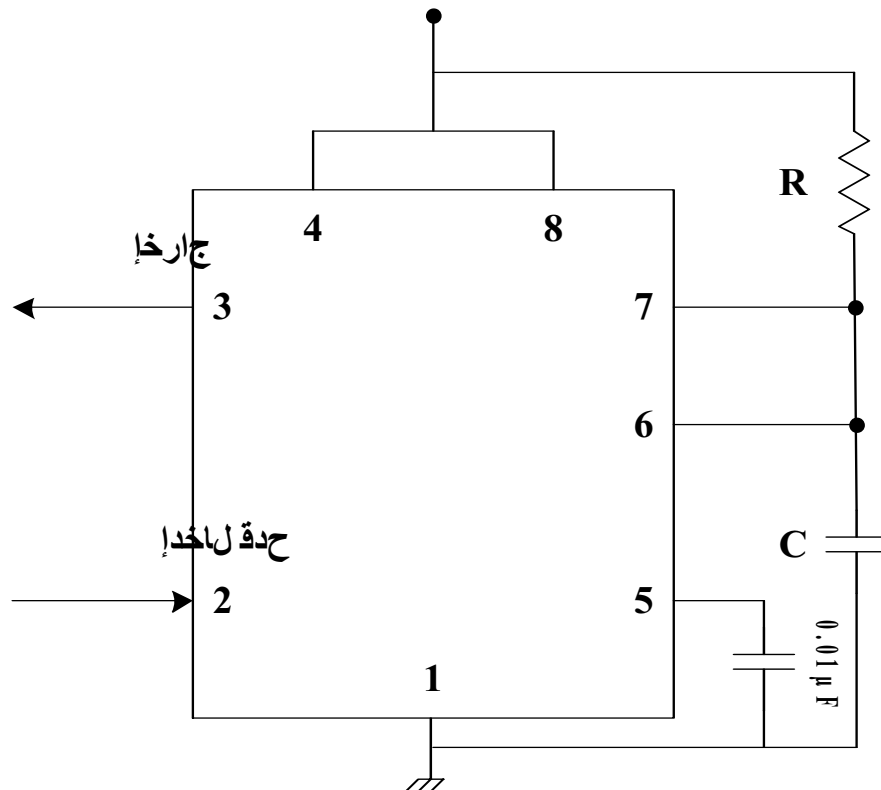
$$R_{L(min)} = \frac{V_{out}}{I_{L(max)}} = \frac{V_{cc} - 1.7}{200mA}$$

Timer 555 As Monostable Multivibrator

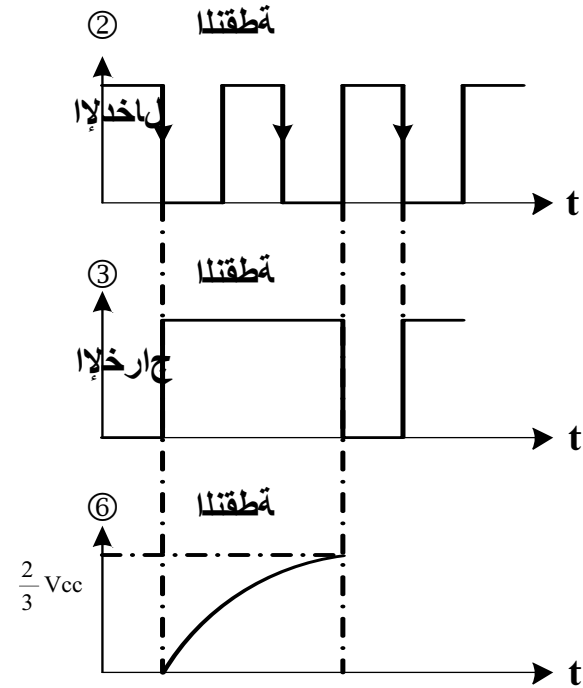
المؤقت 555 بصيغة أحادي الاستقرار

له نفس التسميات التي ذكرناها سابقاً في المهتز أحادي الاستقرار ويستخدم للحصول على نبضة توقيت في الإخراج يكون زمنها أكبر بكثير من عرض (زمن) نبضة القدح المسطرة على طرف القدح (طرف 2) ويبين الشكل أدناه دائرة هذا المؤقت مع أشكال الموجات له:

مولد الاطلاق الواحد أو مولد النبضة الواحدة أو مكبر زمن



(دائرة المؤقت 555 بصيغة أحادي الاستقرار)



(أشكال الموجات الاحادي الاستقرار)

نظرية العمل:

يحصل القذح عندما يصل جهد نبضة القذح $\frac{1}{3} V_{CC}$ أو أقل

(على أن يكون عرض نبضة القذح أقل من عرض نبضة الإخراج المطلوب). وعندها يتحول الإخراج من واطئ إلى عال

وتشحن المتسعة لفترة زمنية $(T=1.1 RC)$ إلى أن يصل الجهد على طرفي المتسعة $\frac{2}{3} V_{CC}$

عندها يتحول الإخراج من عال إلى واطئ. وتستمر هذه الحالة إلى أن تأتي نبضة قذح أخرى كما مبين في الموجات أعلاه.

****** يسمى T عرض نبضة الإخراج أو زمن نبضة الإخراج أو زمن التوقيت.

ملاحظة: (دائرة أحادي الاستقرار هي الدائرة الرئيسية في دوائر التوقيت ذات الاستخدامات العملية الكثيرة ولهذا صنعت دوائر متكاملة للعمل كأحادي الاستقرار من أشهرها الدائرة المتكاملة الرقمية TTL ذات الرقم 74121).

مثال 1: في دائرة 555 كمهزاز أحادي الاستقرار إذا كانت $V_{cc}=14V$ وقيمة المقاومة $4M\Omega$ والتمتعة $1\mu F$ أحسب زمن التوقيت وزمن نبضة الإخراج، وكذلك أحسب أقل قيمة لمقاومة الحمل ممكن ربطها في هذه الدائرة.

الحل: نرسم الدائرة ونثبت المعلومات عليها: $T = \text{زمن نبضة الإخراج} = \text{زمن التوقيت}$

$$T = 1.1RC = 1.1 * 4 * 10^6 * 1 * 10^{-6} = 4.4 \text{ sec}$$

أما أقل قيمة لمقاومة الحمل لهذه الدائرة فهي:

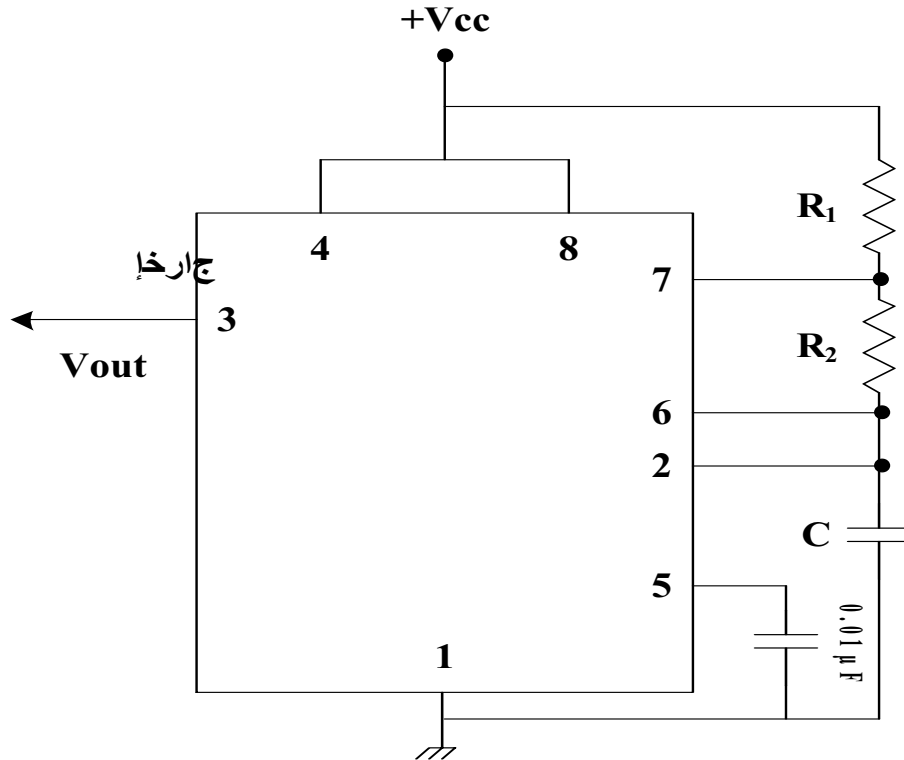
$$R_{L(\min)} = \frac{V_{\text{out}}}{I_{L(\max)}} = \frac{14 - 1.7}{200 * 10^{-3}} = 61.5\Omega$$

ملاحظة: إذا طلب منا التردد فإن الحل يكون بنفس طريقة مثال أحادي الاستقرار في المهتزات والذي تم حله سابقاً.

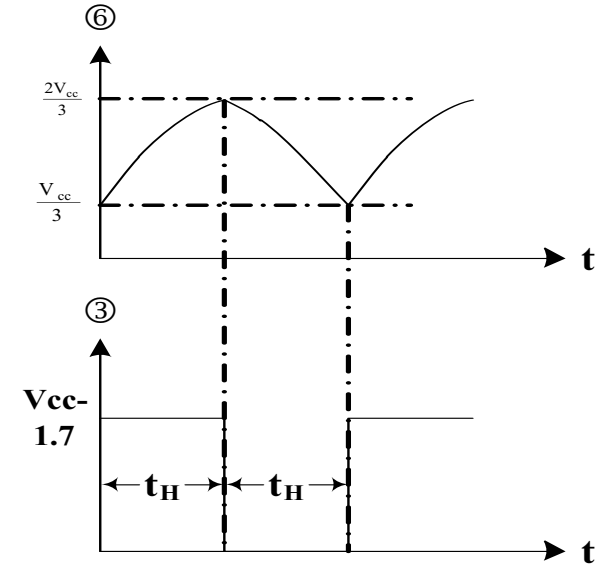
استخدامات الموقت 555 بصيغة مهتز غير مستقر:

Timer 555 in Astable Multi Mode:

وله نفس التسميات في دائرة المهتز غير المستقر السابق إلا أنه مدى الترددات للنبضات المتولدة يكون بين أجزاء الهيرتز إلى 100KHz ويتم ربط الطرف 2 مع الطرف 6 أي أن هذه الدائرة لا إدخال لها كما مبين في الشكل أدناه:



(دائرة الموقت 555 بصيغة مهتز غير مستقر)



(أشكال الموجات)

نظرية العمل لدائرة 555 بصيغة مهتز غير مستقر

عندما نوصل V_{cc} إلى الدائرة يكون جهد النقطة ② أقل من $\frac{1}{3} V_{cc}$

لذلك يتحول الإخراج من مستوى واطئ إلى عالي عندها تبدأ المتسعة بالشحن لزمان t_H وخلال المقاومتين R_1 و R_2 حيث الطرف ⑦ في حالة فتح (Open Circuit).

$$t_H = 0.693(R_1 + R_2).C$$

ويستمر الشحن إلى أن يصل الجهد على طرفي المتسعة إلى $\frac{2}{3} V_{cc}$

عندها يتحول الإخراج من مستوى عال إلى واطئ وتبدأ المتسعة بالتفريغ خلال المقاومة R_2 إلى الطرف ⑦ الذي أصبح دائرة قصر (short cct). ويستمر التفريغ لفترة t_L إلى أن يصل جهد المتسعة إلى $\frac{1}{3} V_{cc}$

$$t_L = 0.693R_2.C$$

عندها يتحول الإخراج من المستوى الواطئ إلى المستوى العالي , وهكذا تعاد الدورة ..

$$\begin{aligned} T &= t_H + t_L = 0.693(R_1 + R_2)C + 0.693R_2C \\ &= 0.693(R_1 + 2R_2)C \end{aligned}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.693(R_1 + 2R_2)C} = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C}$$

ملاحظة :

العلاقة العامة لدورة التشغيل Duty Cycle هي : $D\% = \frac{t_H}{t_H + t_L} * 100\%$

العلاقة الخاصة لهذه الدائرة $D\% = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} * 100\%$ (دائرة 555 بصيغة غير مستقر).

أقل قيمة لـ $D\%$ في هذه الدائرة هي 50% حيث $t_H = t_L$ عندما $R_1 = 0$.

مثال 2: في دائرة المؤقت 555 بصيغة مهتز غير مستقر إذا كانت $R_1=10K\Omega$ ، $R_2=15K\Omega$ ، $C=0.22\mu F$ ، $V_{cc}=15V$ المطلوب إيجاد: 1- تردد موجة الإخراج. 2- زمن موجة الإخراج في المستوى العالي وفي المستوى الواطئ. 3- النسبة المئوية لدورة التشغيل.

الحل: نرسم الدائرة ثم نثبت القيم عليها.

**** تردد الإخراج f:**
$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C} = \frac{1.44}{(10 * 10^3 + 2 * 15 * 10^3) * 0.22 * 10^{-6}} = 164 \text{ Hz}$$

**** زمن المستوى العالي t_H :**
$$t_H = 0.693(R_1 + R_2)C = 0.693(10 * 10^3 + 15 * 10^3) * 0.22 * 10^{-6} = 3.8 \text{ msec}$$

**** زمن المستوى الواطئ t_L :**
$$t_L = 0.693R_2C = 0.693 * 15 * 10^3 * 0.22 * 10^{-6} = 2.29 \text{ msec}$$

أما زمن الموجة T فهو
$$T = t_H + t_L = 3.8 + 2.29 = 6.09 \text{ msec}$$

طريقة ثانية
$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{6.09 * 10^{-3}} = 164 \text{ Hz}$$

**** النسبة المئوية لدورة التشغيل يمكن حسابها بإحدى الطريقتين:**

$$D\% = \frac{t_H}{T} * 100\% = \frac{3.8 \text{ msec}}{6.09 \text{ msec}} * 100\% = 62.45\%$$

أو
$$D\% = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} * 100\% = \frac{10k + 15k}{10k + 2 * 15k} * 100\% = 62.5\%$$

مثال 3 : في دائرة المؤقت 555 كمهتز غير مستقر بتردد 10KHz ودورة تشغيل 75% إذا كانت قيمة المتسعة 0.002μF أحسب R₁ و R₂.

الحل: نرسم الدائرة أولاً ثم نثبت مواقع R₁ و R₂ و C.

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C} \Rightarrow 10 * 10^3 = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2) * 0.002 * 10^{-6}}$$

$$R_1 + 2R_2 = 72 * 10^3 \quad (1) \dots\dots\dots$$

$$\%D = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} * 100\% \Rightarrow 75\% = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} * 100\%$$

$$R_1 + R_2 = 0.75(R_1 + 2R_2) = 0.75 * 72 * 10^3$$

بحل المعادلتين (1) و (2) نحصل على: $R_1 = 18 K$, $R_2 = 36 K$ $R_1 + R_2 = 54 * 10^3 \dots\dots\dots (2)$

طريقة ثانية:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10 * 10^3} = 0.1 msec = 100 msec$$

$$D\% = \frac{t_H}{T} * 100\% \Rightarrow 75\% = \frac{t_H}{0.1 * 10^{-3}} * 100\%$$

$$t_H = 75 msec \quad t_L = T - t_H = 100 - 75 = 25 msec \quad \& \quad t_L = 0.693 R_2 C$$

$$R_2 = \frac{25}{0.693 * 0.002} = 18K$$

$$t_H = 0.693(R_1 + R_2)C \Rightarrow 75 * 10^{-6} = 0.693(R_1 + 18 * 10^3) * 0.002 * 10^{-6}$$

$$\frac{75}{0.002 * 0.693} = R_1 + 18 * 10^3 \quad 54 * 10^3 = R_1 + 18 * 10^3 \quad \therefore R_1 = 36K$$

ملاحظة: بإمكان الطالب الحل بإحدى الطريقتين أعلاه.

طريقة حل المعادلتين 1 و 2 لإيجاد المقاومتين :

$$\cancel{R_1} + 2R_2 = 72 * 10^3 \text{ -----}.1$$

$$\cancel{R_1} + R_2 = 54 * 10^3 \text{ -----}.2$$

-----بالحذف والطرح

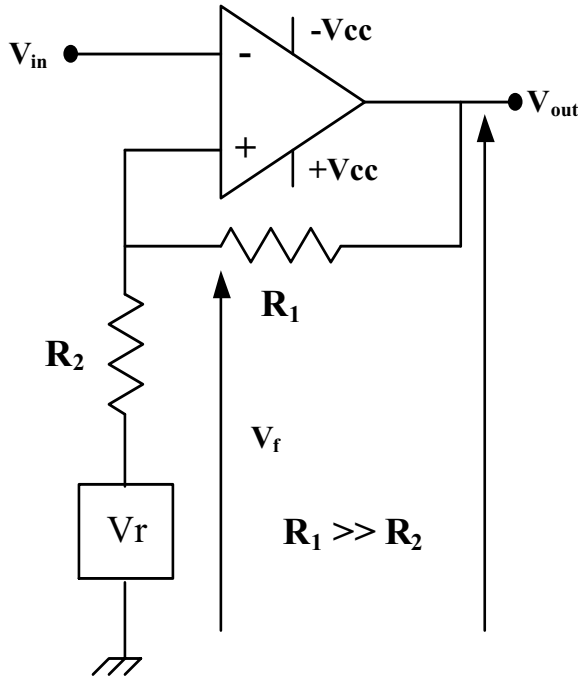
$$2R_2 - R_2 = 18 * 10^3 \implies R_2 = 18 \text{ K}\Omega$$

بالتعويض في 2 ينتج : $R_1 = 54 - 18 = 36 \text{ K}\Omega$

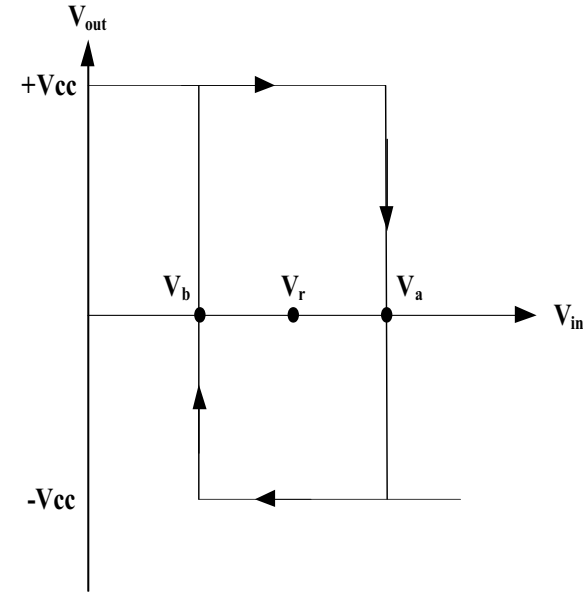
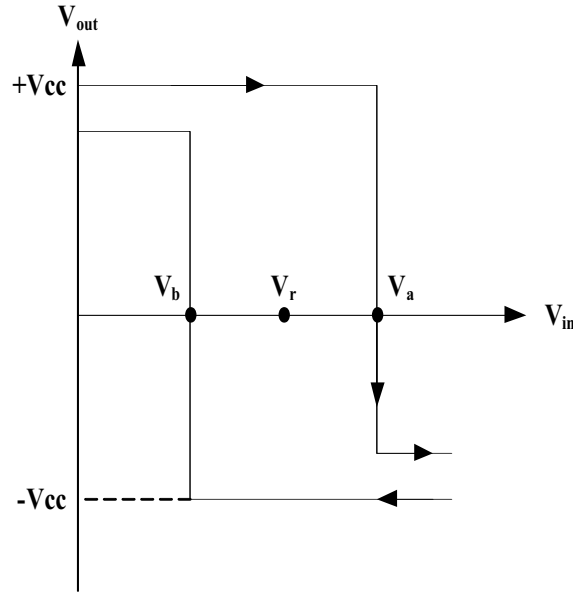
Schmitt Trigger

قـادـح (مـقـدـاح) شـمـيـت

وهي من الدوائر المستخدمة كثيراً في توليد نبضات القـدح لما تمتاز به من مناعة ضد الضوضاء. وقسم من دوائر البوابات المنطقية مثل NAND (الدائرة المتكاملة 7413 والدائرة المتكاملة 74132) و NOT (الدائرة المتكاملة 7414) تعتمد في تركيبها الداخلي قـادـح شـمـيـت . ودائرتـه مركبة من دائرة العبور الصفري ودائرة المقارن التناظري كما موضح في الشكل أدناه، علماً أن قـادـح شـمـيـت يسمى أيضاً مقارن إعادة التوليد (Regenerating Comparator):



(دائرة قـادـح شـمـيـت)



(منحني عمل دائرة قـادـح شـمـيـت (حلقة جهد التخلفية))

حيث أن:

$V_a = V_{Utp}$ (Upper trigger potential) جهد القذح الأعلى

$V_b = V_{Ltp}$ (Lower trigger potential) جهد القذح الأسفل

(Hysteresis Voltage) يسمى جهد التخلفية V_a ، V_b الفرق بين

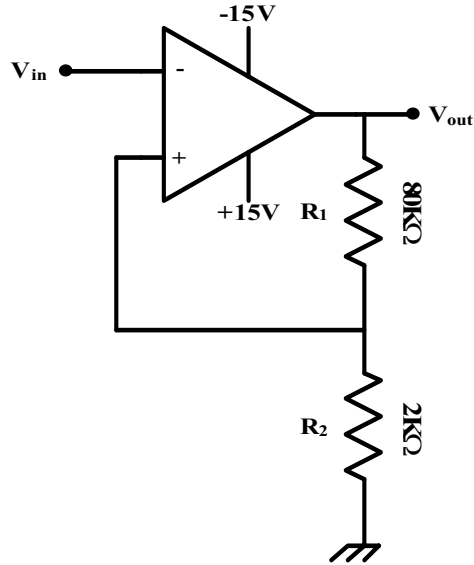
ملاحظة:

ترتبط مباشرة بالأرضي وعندها R_2 أي أن المقاومة short دائرة قصيرة V_r فإن الدائرة تبقى نفسها مع عمل $V_r=0$ عندما تكون $V_r=0$ يكون:

$$V_a = -V_b \text{ \& } V_{Utp} = -V_{Ltp} = \mp \frac{V_{cc}}{R_1 + R_2} * R_2$$

مثال:

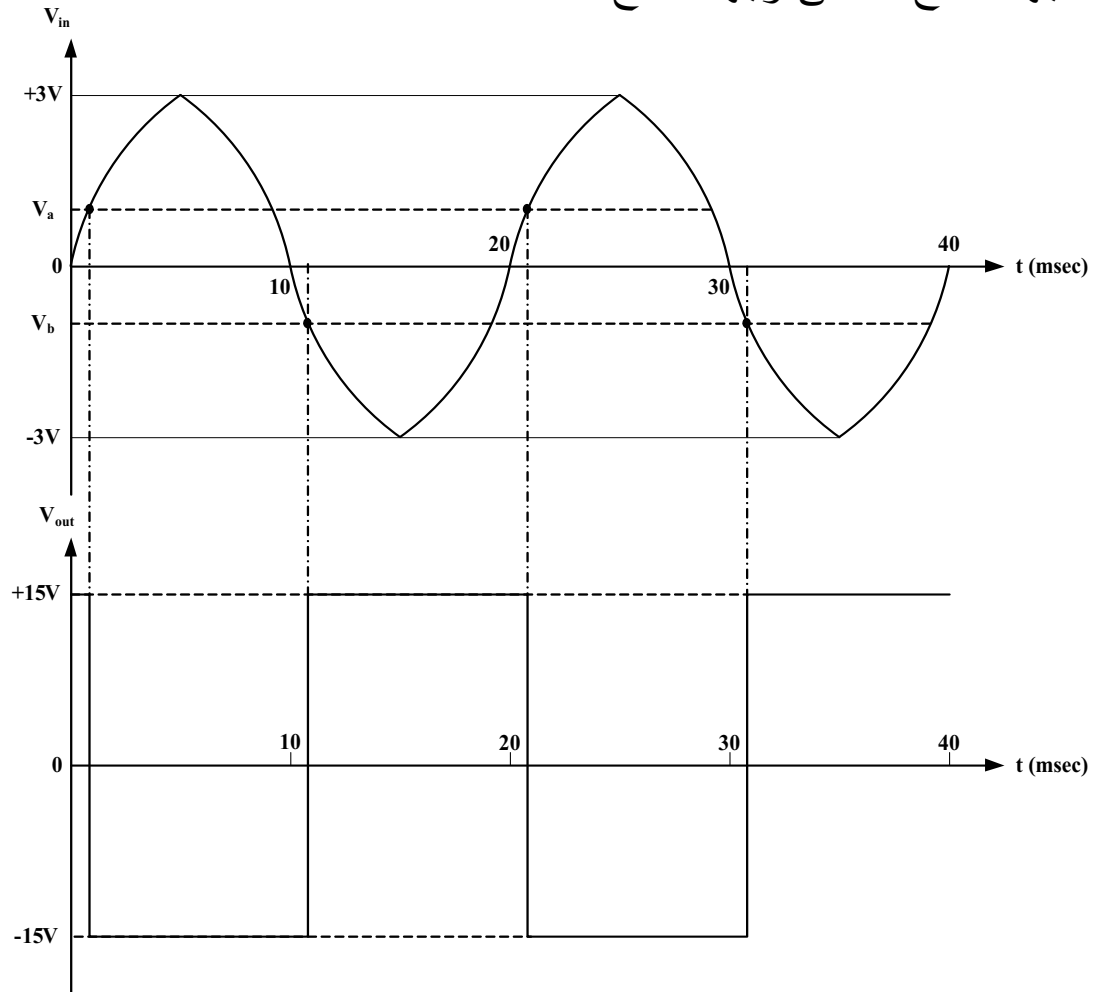
في دائرة قاذح شميث إذا كانت $V_{cc} = \pm 15V$ ، $R_1 = 80K$ ، $R_2 = 2K$ ، أرسم موجة الإخراج نسبة إلى موجة إدخال جيبية بتردد 50 KHz وقيمة 6 Vp-p



الحل: شرط عمل الدائرة ان تكون $R_2 \ll R_1$ أي اكبر بعشر مرات أو أكثر
نرسم الدائرة ثم نحدد القيم عليها ونوجد
جهد القذح الأعلى وجهد القذح الأسفل:

$$V_a = V_{Utp} = \frac{V_{cc} * R_2}{R_1 + R_2}$$
$$= \frac{15 * 2K}{(80 + 2)K} = 0.37V$$

$$V_b = V_{Ltp} = -\frac{V_{cc} * R_2}{R_1 + R_2}$$
$$= -\frac{15 * 2K}{(80 + 2)K} = -0.37V$$



تعتبر دائرة مذبذب شميث إحدى دوائر توليد الموجة المربعة باستخدام مكبر العمليات، وهي بمثابة مهتز غير مستقر بمدى تردد من هذا المدى يختلف عن مدى المهتز غير المستقر باستخدام ترانزستورين وكذلك يختلف عن مدى المهتز غير (10KHz إلى 10Hz المستقر باستخدام مؤقت 555).

نظرية العمل

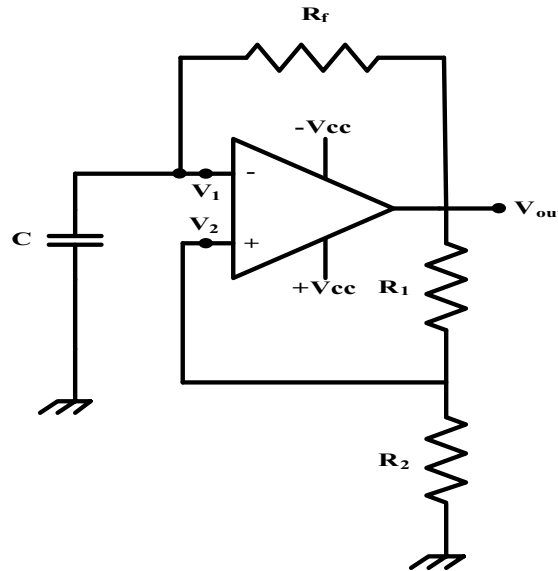
V_1 و V_2 يعتمد على المقارنة بين V_{out} تعتمد فكرة عمل دائرة مذبذب شميث على مبدأ عمل القارن التناظري كلياً، حيث أن الإخراج تشحن لحين يصبح الجهد على طرفيها C فإن المتسعة ($V_2 > V_1$ هذا يعني أن) $(+V_{cc})$ في التشبع الموجب V_{out} فعندما يكون الإخراج بعد ذلك تبدأ المتسعة، $V_1 > V_2$ لأن $(-V_{cc})$ إلى التشبع السالب V_{out} عندها يتحول الإخراج $(+K)$ الذي يساوي V_2 أكبر من جهد (V_1) عن جهد V_2 عن جهد (V_1) بالتفريغ إلى أن يقل الجهد على طرفيها $T_1 = T_2$ وعندها يتحول الإخراج إلى التشبع الموجب وهكذا تستمر عملية شحن وتفريغ المتسعة وبزمن متساوٍ $(-K)$ المساوي (لأن دائرة الشحن هي نفسها دائرة التفريغ).

حيث أن

$$T = T_1 + T_2$$

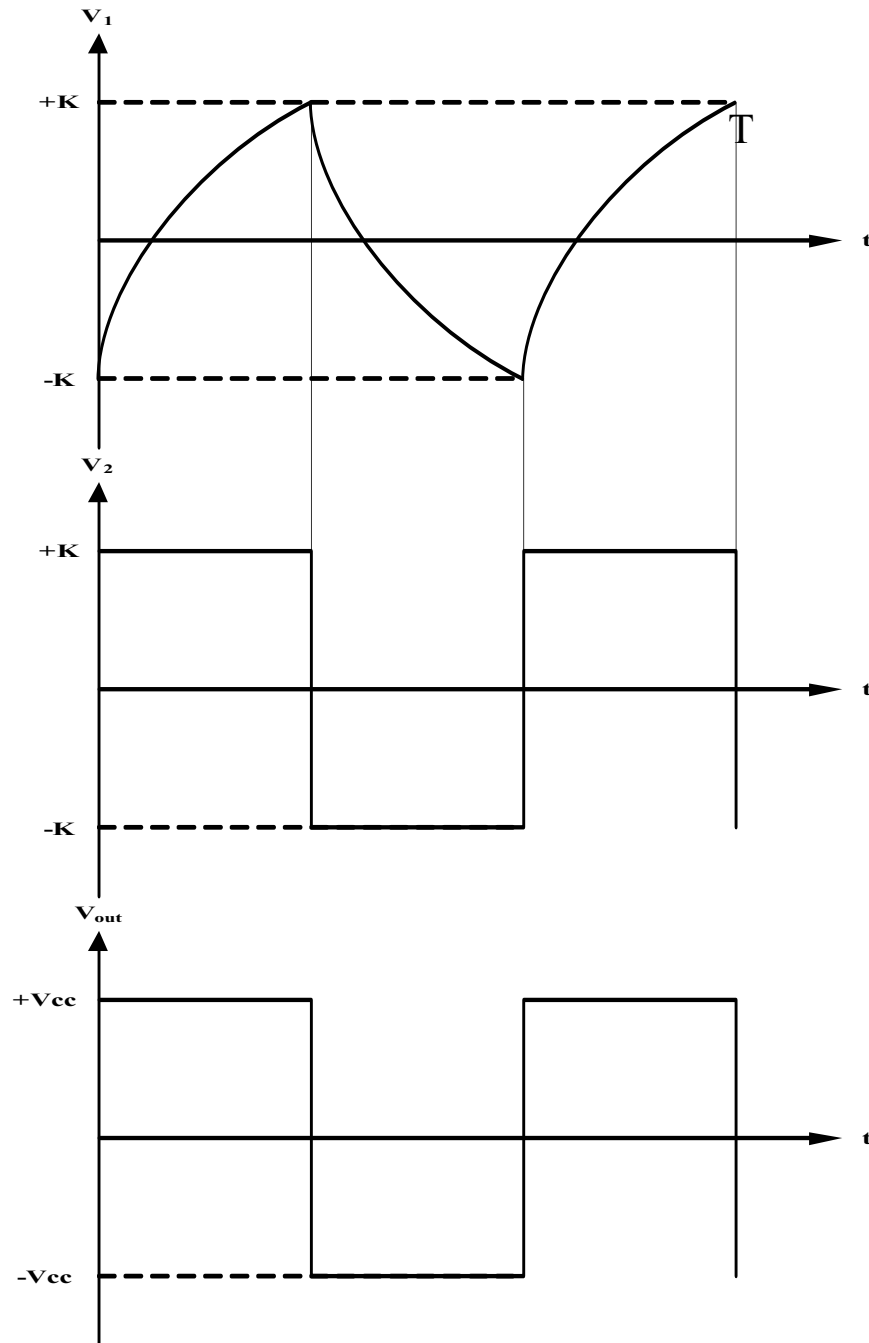
$$T = 2 * C * R_f * \ln \left(1 + 2 * \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$f = \frac{1}{T}$$



دائرة مذبذب شميث

أشكال الموجات لدائرة مذبذب شميث



$$\mp K = \mp \frac{V_{cc} * R2}{R1 + R2}$$

$$T1=T2= \frac{1}{2} T$$

مثال: في دائرة مذبذب شмит إذا كانت $C=0.22\mu F$ ، $V_{cc}=\pm 12V$ ، $R_f=R_1=R_2=10K\Omega$. أحسب تردد موجة الإخراج مع رسم شكل الموجة.

الحل:

أولاً: نرسم الدائرة ثم نثبت القيم عليها بعد ذلك نحسب زمن الموجة ثم التردد.

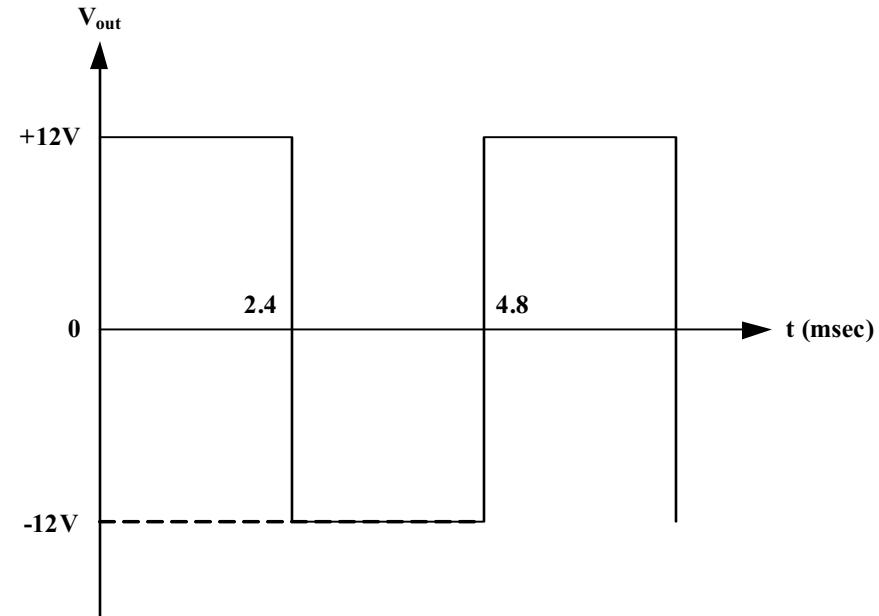
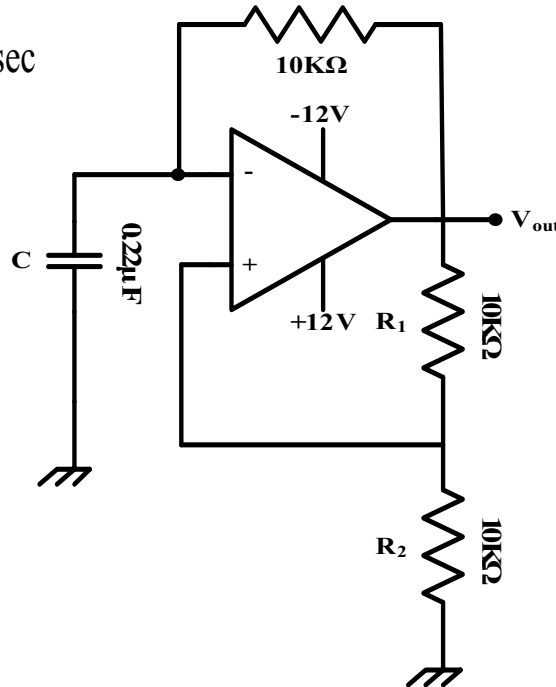
$$T = 2 * C * R_f * \ln \left(1 + 2 * \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$T = 2 * 0.22 * 10^{-6} * 10 * 10^3 * \ln \left(1 + 2 * \frac{10K\Omega}{10K\Omega} \right)$$

$$= 0.44 * 10^{-2} * \ln(3)$$

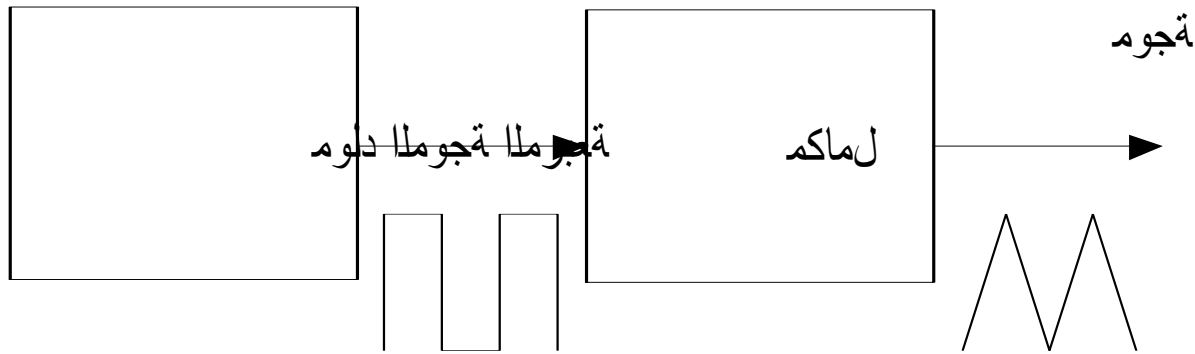
$$= 0.44 * 10^{-2} * 1.1 = 4.84 \text{ msec}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4.84 * 10^{-3}} = 207 \text{ Hz}$$



مولد الموجة المثلثة

احدى الدوائر المستخدمة في توليد الموجة المثلثة هي المبين مخططها الكتلي أدناه علماً ان تردد الموجة المثلثة هو نفس تردد موجة الإدخال المربعة.



مذبذب أحادي الاستقرار (مولد النبضة) باستخدام محرك العمليات

له نفس التسميات التي ذكرناها في دائرتي أحادي الاستقرار السابقتين (أحادي الاستقرار باستخدام ترانزستورين وأحادي الاستقرار باستخدام مؤقت 555) وله نفس المبدأ أيضاً حيث له حالة مستقرة وحالة غير مستقرة. ويبين الشكل أدناه رسم الدائرة:

نظرية عمل الدائرة

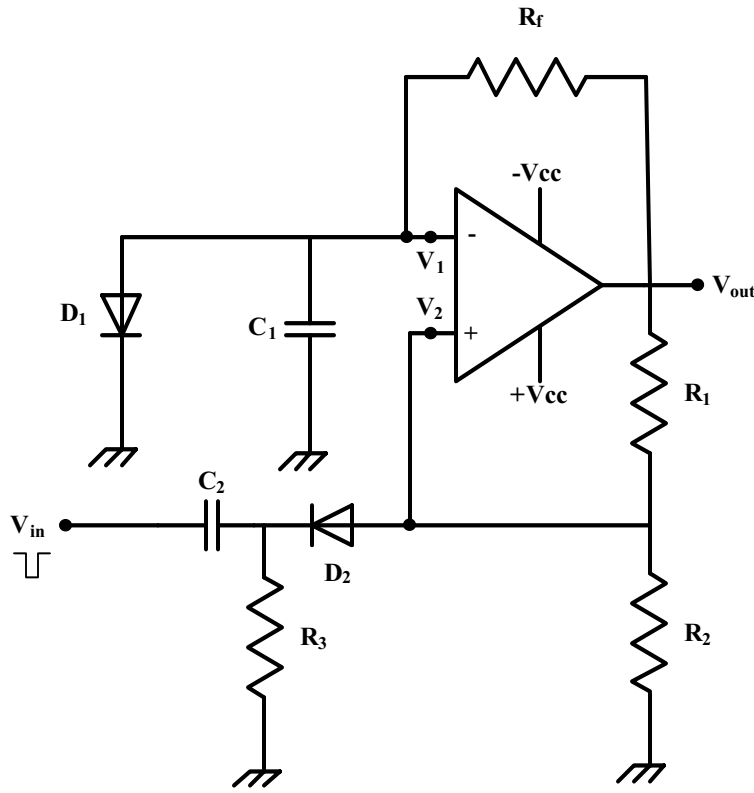
تعتمد فكرة عمل الدائرة على مبدأ المقارن التناظري كما هو الحال في دائرة مذبذب شميت.

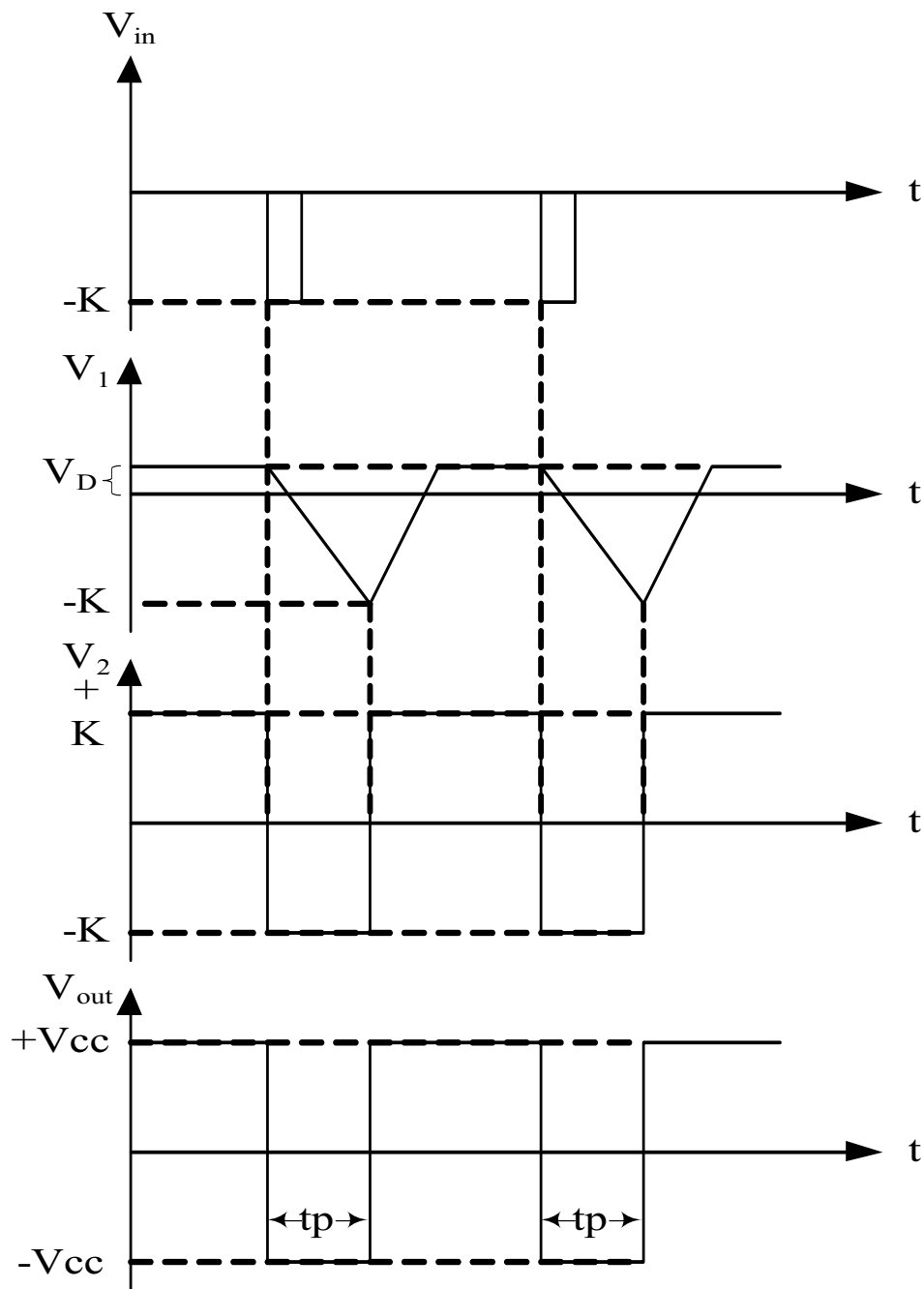
فعند عدم وجود نبضة قذح سالبة V_{in} فإن الإخراج يكون في التشبع الموجب $V_{cc}+$ وهي حالة الاستقرار بسبب ان الثنائي $D1$ يكون $V2 > V1$ وبهذا يكون $+K$ المساوي $V2$ أصغر من $V1$ الذي يمثل (الجرمانيوم للـ $0.3V$ أو $0.7V$) منحاز أمامياً وجهده ينحاز أمامياً $D2$ فإن الثنائي $-K$ ذو قيمة V_{in} وتستمر حالة الاستقرار ما لم تأتي نبضة قذح سالبة. أما عند مجيء نبضة قذح سالبة مما (وهي الحالة الغير المستقرة) $-V_{cc}$ فعندها يتحول الإخراج إلى التشبع السالب $V1 > V2$ وهذا يعني أن $-K$ مساوية $V2$ مما يجعل أقل من $(V1)$ بالشحن بالاتجاه السالب ويستمر إلى أن يصبح الجهد على طرفيها وهو $C1$ ينحاز عكسياً وتقوم المتسعة $D1$ يجعل حيث t_p ويستمر الشحن لفترة زمنية تمثل عرض نبضة الإخراج $-K$

$$t_p = \frac{R_2}{R_1} * C_1 * R_f$$

عندها يكون $V2 > V1$ ويتحول الإخراج إلى التشبع الموجب $V_{cc}+$ وهي حالة الاستقرار.

(دائرة أحادي الاستقرار (مولد النبضة))





أشكال الموجات لمولد النبضة (أحادي الاستقرار)
 باستخدام مكبر العمليات

$$K = V_{cc} * \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

Active Filters المرشحات النشطة

هي الدوائر التي تقوم بترشيح وتكبير الترددات المطلوبة وقطع الترددات الأخرى، وتتألف من مقاومات ومتسعات ومكبر عمليات. ولها محاسن ومساوي هي

المحاسن Advantages

- صغيرة الحجم وخفيفة الوزن بسبب عدم استخدام المحاثات.
- تعمل على تكبير الإشارات بالإضافة إلى الترشيح.
- تعمل كعازل بسبب ممانعة المكبر العالية.
- تعمل بالترددات العالية تصل إلى 1MHz.
- تعمل بالترددات القليلة تصل إلى 1Hz.
- لها وثوقية عالية (مضمونة العمل) .
- سهولة التصميم .

المساوي Disadvantages

- تحتاج إلى مجهزات قدرة $(V_{cc} \pm)$.
- قد تتأثر بالضوضاء مما يحولها إلى مهتزازات.
- الإدخال والإخراج محدود $(V_{cc} \pm)$ كما أن تيار الإخراج محدود (بالمللي أمبير) .
- IC's عالية , نحتاج إلى مقاومات ومتسعات ذات حجم كبير وعدد من الـ Q للحصول على عامل جودة •

Active LPF

مرشح الإمرار الواطئ المنغلق

ويقوم بإمرار الترددات الواطئة فقط وتكبيرها، ودائرته مبينة أدناه:

نظرية عمل الدائرة

كدائرة مفتوحة عند الترددات الواطئة وتعمل الدائرة كمكبر-قالب $\frac{R_2}{R_1}$ تكبير A كبير C_1 تظهر المتسعة

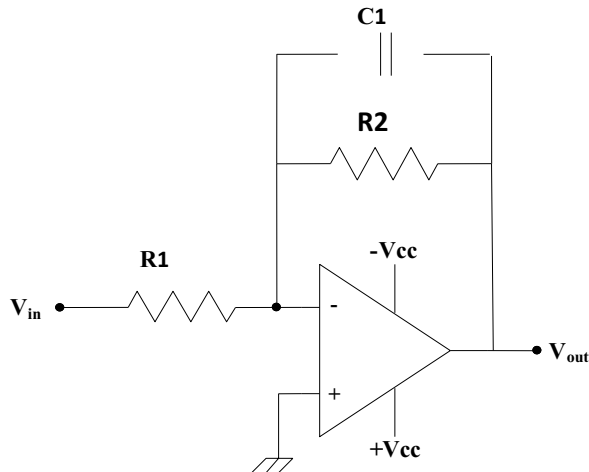
$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi f C_1}$$

ومع زيادة التردد تقل المفاعلة السعوية X_{C1} وعندما يزداد التردد بصورة كبيرة جداً تبدو المتسعة كدائرة قصر (short) ويقترب التكبير من الصفر كما يوضح هذا منحنى الاستجابة الترددية حيث يكون التكبير عالي في الترددات القليلة. وعندما يتساوى التردد مع تردد القطع أو (التردد الحرج) فإن التكبير يهبط بمقدار 3dB عن أعظم تكبير A (لأن $A_v = \frac{A}{\sqrt{2}}$)

بعد هذا التردد يهبط التكبير بمعدل كبير إلى أن يصل صفر تقريباً.

ملاحظة:

تردد القطع يسمى أيضاً التردد الحرج (critical freq).

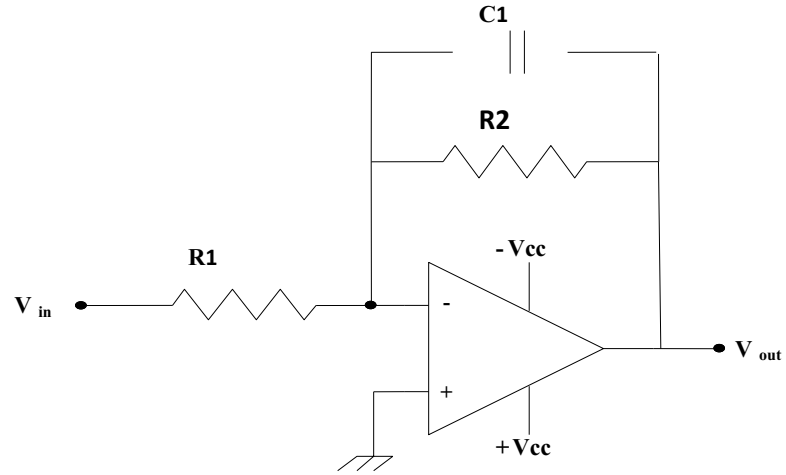


اشتقاق معادلة تردد القطع f_c :

$$Z_1 = R_1 \text{ \& \; } Z_2 = R_2 \parallel \left(\frac{1}{j\omega C_1} \right)$$

$$\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{\frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{1}{R_2} + j\omega C_1 = \frac{1 + j\omega R_2 C_1}{R_2}$$

$$\therefore Z_2 = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_1}$$



$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_1} = -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{1 + j\omega R_2 C_1} = -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{\sqrt{(1)^2 + (\omega R_2 C_1)^2}}$$

عند تردد القطع (cutoff freq.) يهبط التكبير بمقدار 3dB وعندها يكون:

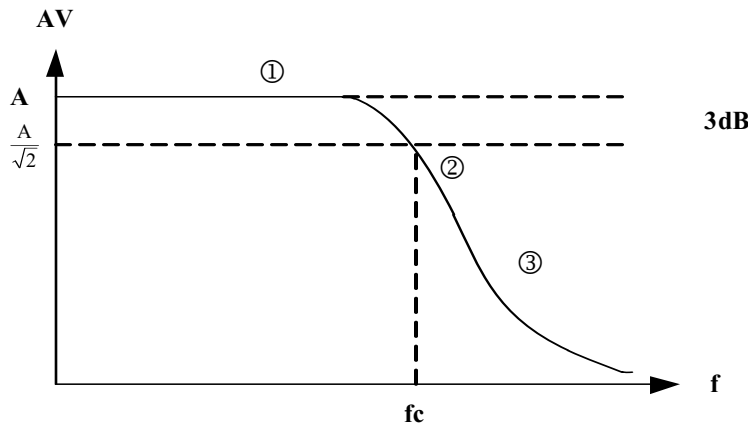
$$\omega_c R_2 C_1 = 1 \implies 2\pi f_c R_2 C_1 = 1$$

$$\therefore f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C_1}$$

سؤال: من أين أتت الـ 3dB؟

الحل: عند تردد القطع يكون التكبير 0.707 من التكبير الأعلى وعليه ومن تطبيق قانون التكبير بالـ dB

عامل التكبير بالديسيبل $Av \text{ (indB)} = 20\log_{10} Av = 20\log_{10} 0.707 = 20 * 0.15 = 3\text{dB}$



1- عند الترددات الواطئة (قبل تردد القطع بكثير) بالإمكان إهمال تأثيرات C_1 المتسعة : لذا تصبح معادلة التكبير كالآتي

$$Av_1 = -\frac{R_2}{R_1}$$

2- عند تردد القطع f_c :

$$Av_2 = -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{\sqrt{1^2 + (WR_2C_1)^2}}$$

$$= -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{لأن } WR_2C_1=1)$$

3- بعد تردد القطع بكثير أي $f \geq 10 f_c$ بالإمكان إهمال تأثير R_2 : $Av_3 = -\frac{R_2}{R_1 * WR_2C_1} = -\frac{1}{R_1 * WC_1} = -\frac{1}{2 f R_1 C_1}$

ملاحظة: C_1 متغيرة تسمح بتغيير تردد القطع f_c و R_1 متغيرة للتحكم بالتكبير Av .

مثال: في دائرة مرشح الامرار الواطئ الفعّال إذا كانت $R_1=1K\Omega$ ، $R_2=100K\Omega$ ، $C=160PF$. أوجد تردد القطع وارسم منحنى الاستجابة الترددية للدائرة.

الحل:

نرسم الدائرة ونثبت عليها القيم ثم نحسب تردد القطع وقيم التكبير في ثلاثة مناطق مختلفة للتردد لكي نتمكن من رسم منحنى الاستجابة الترددية للمثال وكما يلي:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_2 C_1} = \frac{1}{2 * 3.14 * 100 * 10^3 * 160 * 10^{-12}} = 10KHz$$

$$A_{V_1} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{100 * 10^3}{1 * 10^3} = -100 \Rightarrow 40dB$$

$$A_{V_2} = -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{\sqrt{2}} = -100 * \frac{1}{\sqrt{2}} = -70.7 \Rightarrow 37dB$$

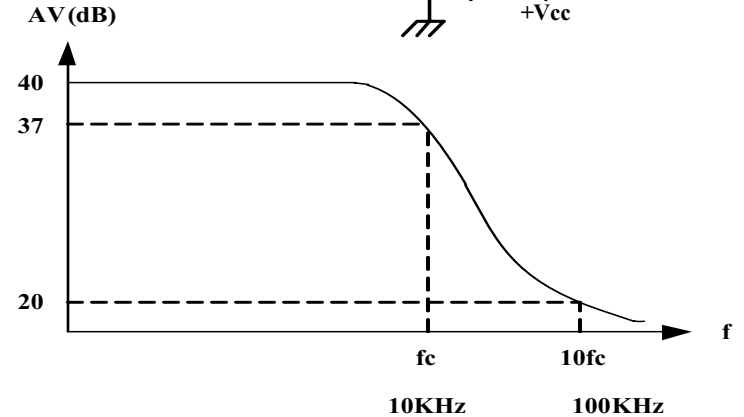
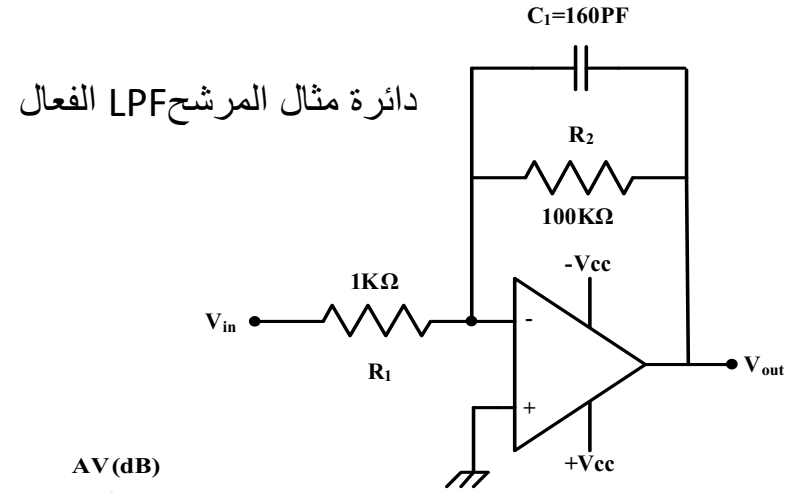
$$= 40 - 3 = 37dB \text{ أو}$$

$$A_{V_3} = -\frac{1}{2\pi f R_1 C_1} = -\frac{1}{2 * 3.14 * 100 * 10^3 * 1 * 10^3 * 160 * 10^{-12}}$$

$$= -10 \Rightarrow 20dB$$

عند $f = 10f_c$

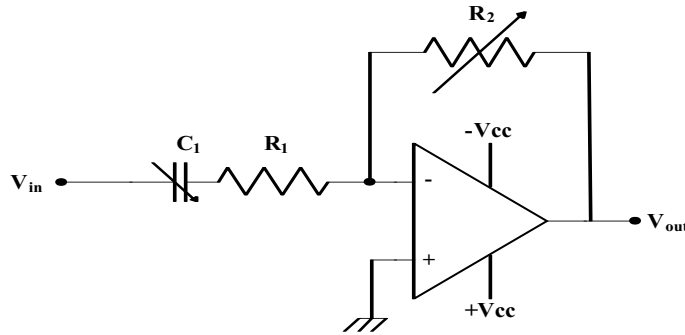
منحنى الاستجابة للمثال



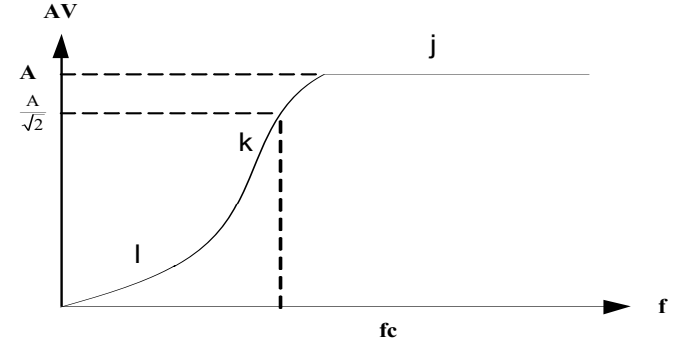
Active HPF

مرشح الإمرار العالي النفعال

يهدف إلى إمرار الترددات العالية فقط وتكبيرها ، ودائرته ومنحني الاستجابة الترددية له كما مبين أدناه :



دائرة مرشح HPF النفعال



منحني الاستجابة الترددية لمرشح HPF النفعال

نظرية عمل الدائرة:

عند الترددات القليلة فإن المتسعة C_1 تبدو كدائرة مفتوحة ويكون التكبير صفر تقريباً، ومع ازدياد التردد تقل المفاعلة السعوية ويزداد التكبير تدريجياً لحين تساوي التردد مع تردد القطع فإن

$$Av_2 = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

وعندها يكون التكبير أعلى ما يمكن (short) وفي الترددات العالية أكبر من تردد القطع فإن المتسعة تتصرف كدائرة قصيرة .

$$A = -\frac{R_2}{R_1} \quad Av_1 = A \quad \text{حيث}$$

لأن الدائرة تبدو كمكبر قالب. نظرية العمل هذه تكون واضحة من خلال منحني الاستجابة الترددية.

وهذا يتحقق عندما A عن القيمة العليا للمكبر dB عند تردد القطع يقل عامل التكبير بمقدار 3 dB * $\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$2\pi f_c R_1 C_1 = 1 \Rightarrow f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

أما عامل التكبير فيمكن حسابه من العلاقات التالية:

1- عند الترددات العالية : وبعد إلغاء تأثير المتسعة باعتبارها دائرة قصر

$$A_{v_1} = -\frac{R_2}{R_1}$$

2- عند تردد القطع :

$$A_{v_2} = -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{\sqrt{1^2 + (WR_1C_1)^2}} = -\frac{R_2}{R_1} * \frac{1}{\sqrt{2}}$$

3- عند الترددات الواطئة $f \leq \frac{fc}{10}$ وبعد إلغاء تأثير R_1 قياسا بتأثير C_1

$$A_{v_3} = -\frac{R_2}{\frac{1}{jWC_1}} = -jWC_1R_2 = -WR_2C_1$$

ملاحظة: C_1 متغيرة لتغيير تردد القطع R_2 متغيرة للتحكم بالتكبير.

مثال:

في دائرة مرشح الامرار العالي الفعّال HPF إذا كانت $R_1=33K\Omega$ ، $R_2=330K\Omega$ و $C_1=47nF$. أوجد تردد القطع ثم أرسم منحنى الاستجابة الترددية للدائرة.

الحل:

أولاً: نرسم الدائرة ثم نثبت عليها القيم ثم نوجد تردد القطع وقيم التكبير في ثلاثة نقاط مختلفة التردد لكي نتمكن من رسم منحنى الاستجابة الترددية.

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \quad \text{تردد القطع}$$

$$= \frac{1}{2 * 3.14 * 33 * 10^3 * 47 * 10^{-9}} = 100Hz$$

$$A_{V_1} = -\frac{R_2}{R_1} = -\frac{330 * 10^3}{33 * 10^3} \\ = -10 \Rightarrow 20dB$$

التكبير عند الترددات العالية

$$A_{V_2} = 20 - 3 = 17dB$$

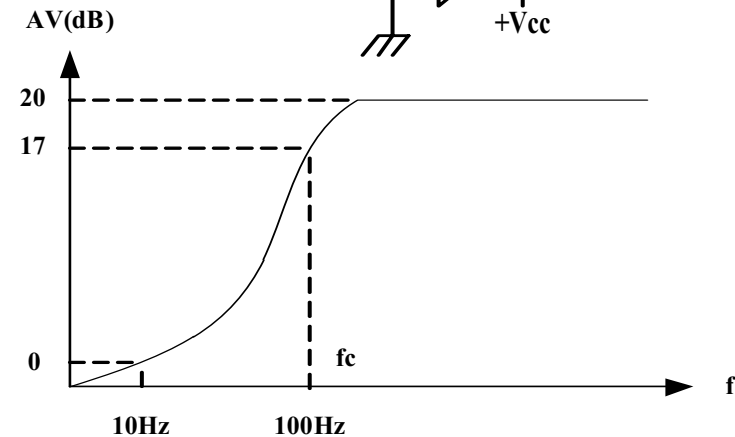
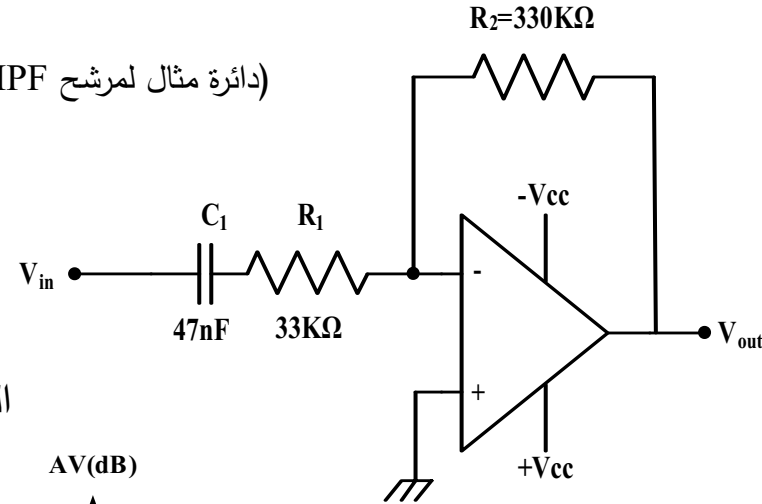
التكبير عند تردد القطع

$$A_{V_3} = -2\pi f R_2 C_1 = -2\pi * 10 * 330 * 10^3 * 47 * 10^{-9} \\ = -1 \Rightarrow 0dB$$

التكبير عند تردد واطئ

$$f = \frac{f_c}{10}$$

(دائرة مثال لمرشح HPF الفعّال)



(منحنى الاستجابة الترددية لمثال مرشح HPF الفعّال)

Feedback

التغذية الخلفية (العكسية)

تعريفها

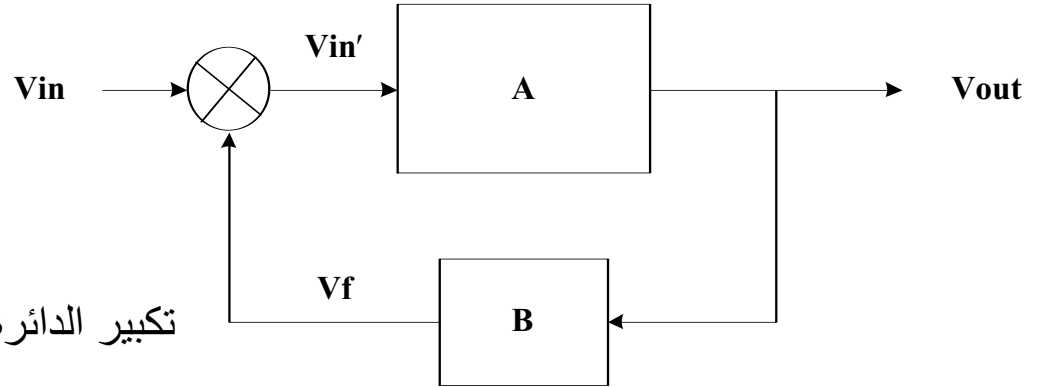
وهي أخذ جزء من إشارة الإخراج وإرجاعها كإشارة إدخال (رئيسي أو إضافي) للدائرة، وتكون على نوعين: الموجبة التي تستخدم في المذبذبات والسالبة التي تستخدم في المكبرات. ويوضح المخطط أدناه فكرة التغذية الخلفية.

$$A = \frac{V_{out}}{V_{in'}} \quad \text{تكبير الدائرة المفتوحة:}$$

$$B = \frac{V_f}{V_{out}} \quad \text{عامل التغذية الخلفية:}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A}{1 \mp AB} \cong \frac{1}{B}$$

تكبير الدائرة المغلقة:



اشتقاق علاقة A_v :

$$V_{in'} = V_{in} \mp BV_{out}$$

$$V_{out} = AV_{in'} = A(V_{in} \mp BV_{out})$$

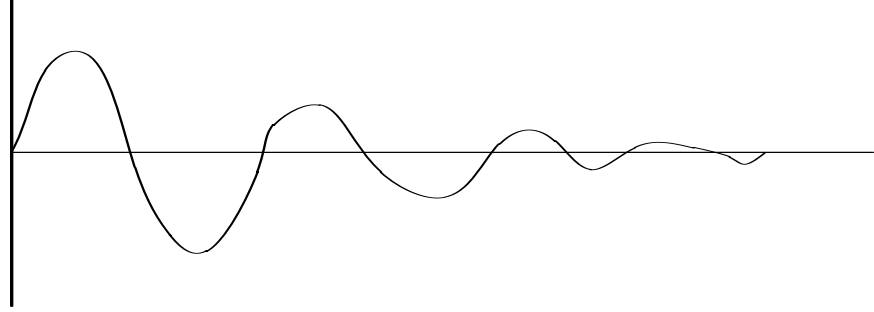
$$V_{out} = AV_{in} \mp ABV_{out}$$

$$V_{out} \mp ABV_{out} = AV_{in}$$

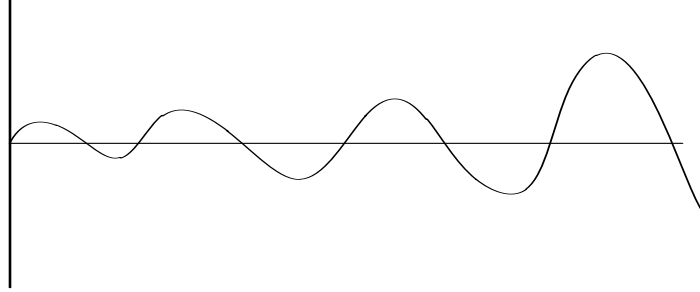
$$V_{out}(1 \mp AB) = AV_{in}$$

$$\therefore \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A}{1 \mp AB} = A_v \quad \text{و.ه.م.}$$

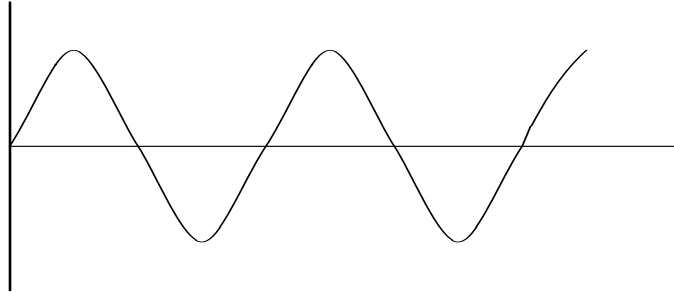
• إذا كانت $AB < 1$ تتلاشى الإشارة بالتدرج لأننا نقوم بإعادة جهد تغذية تتناقص قيمتها (تغذية خلفية سالبة).



• إذا كانت $AB > 1$ تنامي الإشارة بالتدرج لأن الإشارة المعاد تغذيتها تزداد قيمتها (تغذية عكسية موجبة).



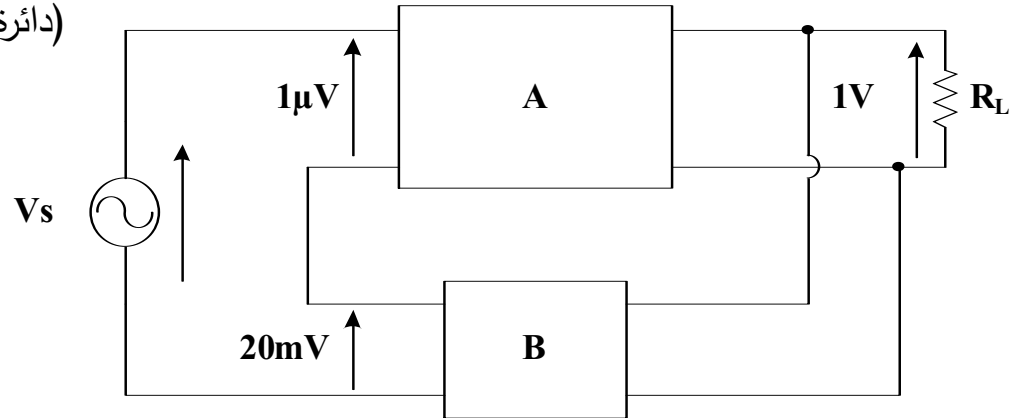
• إذا كانت $AB = 1$ تبقى الإشارة ثابتة لأن الإشارة المعاد تغذيتها تبقى ثابتة القيمة (حالة تذبذب).



مثال:

في الدائرة المبينة أدناه، أحسب : A، B و AV.

(دائرة المثال المعطاة)



الحل:

عند مناظرة دائرة المثال المعطاة مع مخطط التغذية الخلفية نستنتج ما يلي:

$$V_f = 20mV, V_{in'} = 1mV, V_{out} = 1V, V_{in} = V_s = 20.001mV$$

$$A = \frac{V_{out}}{V_{in'}} = \frac{1V}{1mV} = \frac{10^6 mV}{1mV} = 10^6$$

وعليه يمكن إيجاد المطلوب كما يأتي:

$$B = \frac{V_f}{V_{out}} = \frac{20mV}{1V} = \frac{20mV}{1000mV} = 0.02$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{20.001mV} = \frac{1000mV}{20.001mV} = 50$$

Oscillators

المذبذبات

وهي دوائر الكترونية تقوم بتوليد موجات جيبية (بدون إشارة إدخال خارجية) باستخدام مبدأ التغذية الخلفية الموجبة، وتستعمل المذبذبات في دوائر الإرسال لتوليد الموجات الحاملة (Carrier Waves) وفي دوائر الاستقبال لتوليد التردد البيني (IF).

شروط التذبذب

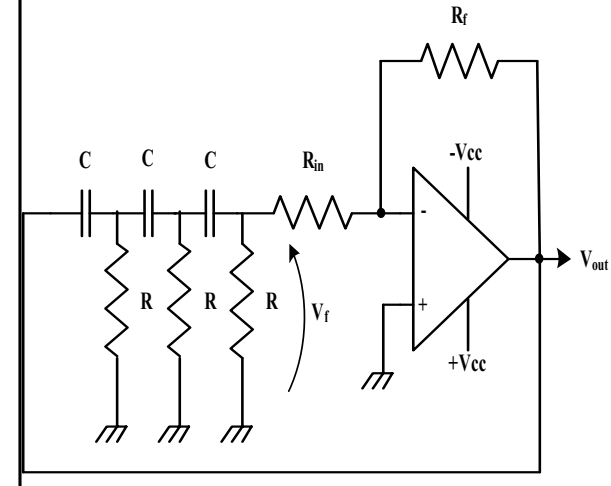
- ☐ وجود فرق طور 0° أو 360° (أي تغذية خلفية موجبة) بين V_f و V_{out} .
- ☐ $AB=1$ (في البداية أكبر من واحد ثم تقل إلى الواحد) .
- ☐ وجود فولتية بدء (شوشرة) noise.

جدول مقارنة بين بعض أنواع المذبذبات

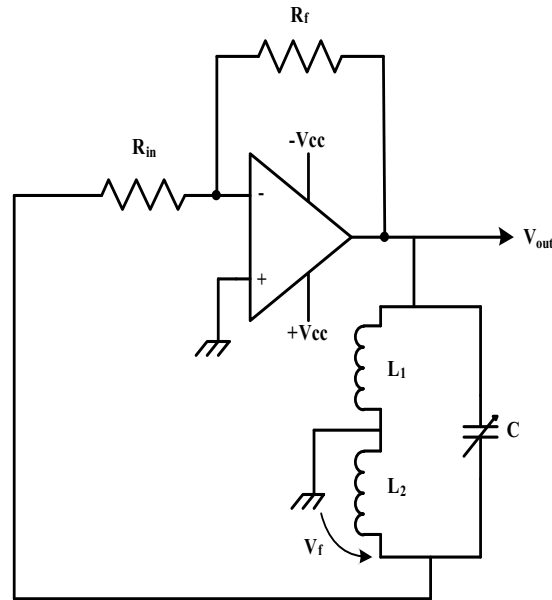
مذبذب كولبيتس	مذبذب هارتلي	مذبذب إزاحة الطور
1. يقوم بتوليد موجة جيبية ذات ترددات عالية تصل إلى أكثر من 500MHz. 2. تردد التذبذب (الرنين). $f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{6RC}}$ 3. عامل التغذية الخلفية . $B = \frac{1}{29}$ 4. تكبير المكبر . $\left[A = \frac{R_f}{R_{in}} \right] 29 \leq A$ 5. تتألف دائرة التغذية الخلفية من متسعتين C₁ و C₂ وملف L تقوم بإزاحة 180° ويقوم المكبر بإزاحة 180° فينتج 360°.	1. يقوم بتوليد موجة جيبية ذات ترددات عالية تصل إلى أكثر من 500MHz. 2. تردد التذبذب (الرنين). $f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} ; L = L_1 + L_2$ 3. عامل التغذية الخلفية . $B = \frac{L_2}{L_1}$ 4. تكبير المكبر . $A = \frac{R_f}{R_{in}} \quad \frac{L_1}{L_2} \leq A$ 5. تتألف دائرة التغذية الخلفية من ملفين L₁ و L₂ ومتسعة C تقوم بإزاحة طور 180° ويقوم المكبر بإزاحة 180° فينتج 360°.	1. يقوم بتوليد موجة جيبية بمدى تردد من 5Hz إلى 800KHz. 2. تردد التذبذب (الرنين). $f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} ; C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ 3. عامل التغذية الخلفية . $B = \frac{C_1}{C_2}$ 4. تكبير المكبر . $A = \frac{R_f}{R_{in}} \quad \frac{C_2}{C_1} \leq A$ 5. تتألف دائرة التغذية الخلفية من ثلاثة مراحل RC تقوم بإزاحة طور 180° ويقوم المكبر بإزاحة 180° فينتج 360°.

تكملة جدول المقارنة

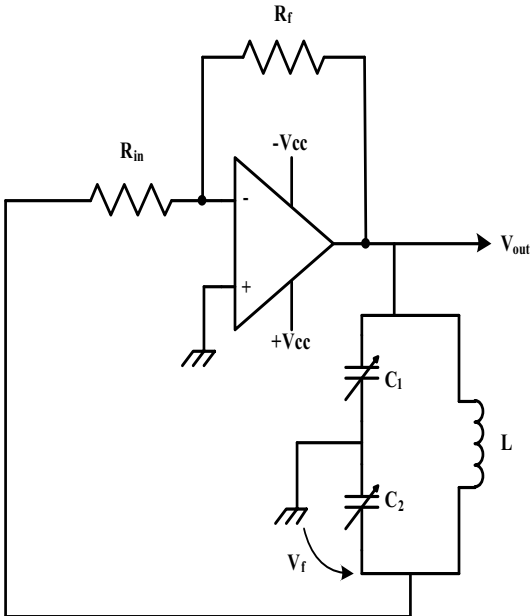
6. رسم الدائرة كما يلي:



6. رسم الدائرة كما يلي:



6. رسم الدائرة كما يلي:



ملاحظة: بالنسبة لمذبذب كولبيتس إذا أضيفت متسعة C3 على التوالي مع الملف L فإن الدائرة تكون أكثر استقرار وتسمى عندئذ مذبذب كلاب، وتصبح المتسعة المكافئة لغرض استخدامها في قانون تردد التذبذب هي:

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} \cong C_3$$

مثال:

في دائرة مذبذب إزاحة الطور إذا كانت $R=10K\Omega$ ، $C=1nf$ ، $R_{in}=5K\Omega$. أحسب تردد التذبذب وقيمة المقاومة R_f اللازمة لعمل الدائرة.

الحل:

نرسم الدائرة ونثبت عليها القيم ثم نوجد f_o و R_f كما يلي:

تردد التذبذب $f_o = \frac{1}{2p \sqrt{6RC}}$

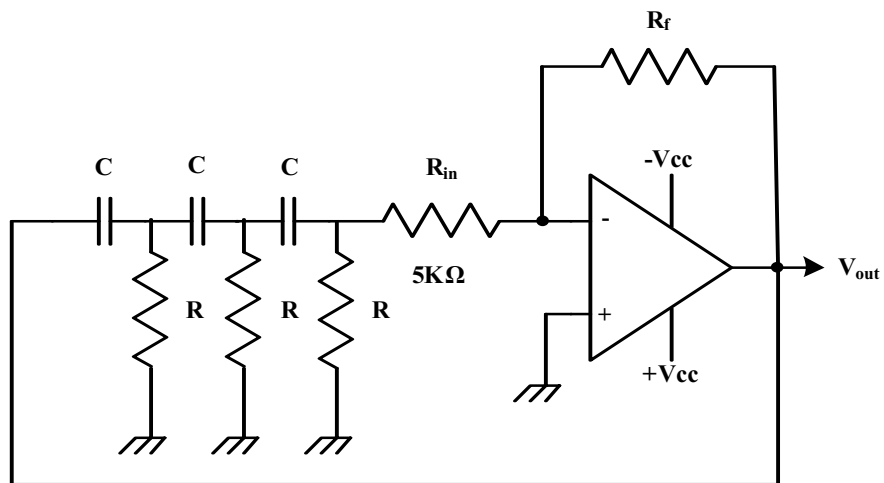
$$= \frac{1}{2p \sqrt{6 * 10 * 10^3 * 1 * 10^{-9}}}$$

$$= 6501Hz = 6.5KHz$$

$$A = 29 = \frac{R_f}{R_{in}}$$

$$\therefore R_f = A * R_{in}$$

$$= 29 * 5K\Omega = 145K\Omega$$



R=10KΩ & C=1nf

مثال:

في دائرة مذبذب هارتللي إذا كانت $L_1=1\text{mH}$ ، $L_2=0.1\text{mH}$ ، $C=0.1\mu\text{f}$ ، $R_{in}=10\text{k}\Omega$ أوجد تردد التذبذب وقيمة المقاومة R_f اللازمة لعمل الدائرة.

الحل:

نرسم الدائرة ثم نثبت القيم عليها ونوجد f_0 و R_f كما يلي:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{تردد التذبذب}$$

$$L = L_1 + L_2$$
$$= 1 + 0.1 = 1.1\text{mH}$$

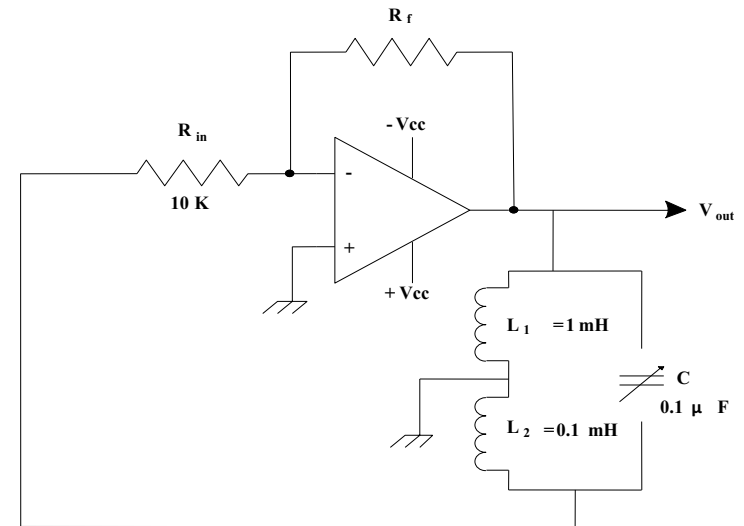
$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{1.1*10^{-3} * 0.1*10^{-6}}}$$

$$= 15923\text{Hz} = 15.9\text{KHz}$$

$$B = \frac{L_2}{L_1} = \frac{0.1\text{mH}}{1\text{mH}} = 0.1$$

$$A = \frac{1}{B} = \frac{1}{0.1} = 10$$

$$A = \frac{R_f}{R_{in}} \quad \therefore R_f = A * R_{in} = 10 * 10\text{K} = 100\text{K}\Omega$$



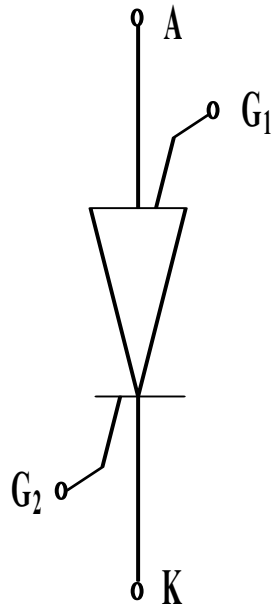
مقاومة التغذية العكسية اللازمة لعمل الدائرة

عائلة الثايرستور



SUS

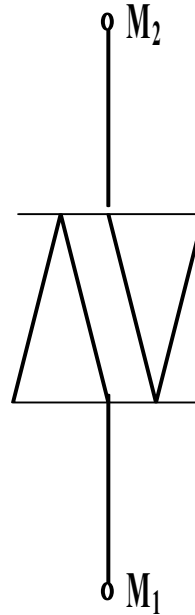
Silicon Unilateral Switch



SCS

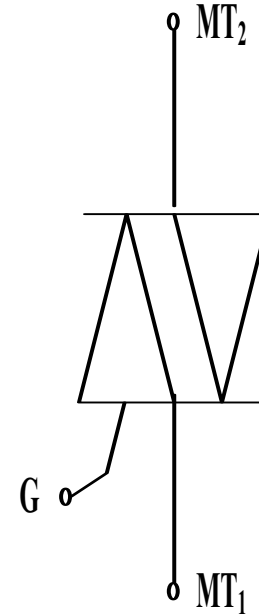
Silicon Controlled Switch

مكثف ي نوكليليس حاتفم
ماجتلا ي مامأ ي نوكليليس حاتفم



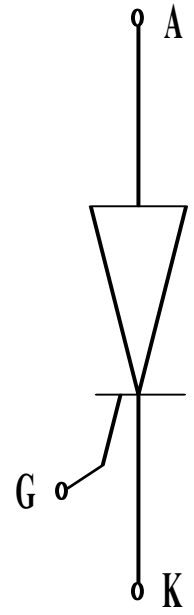
Diac

لكايات



Triac

لكايات



SCR

Silicon Controlled Rectifier

نوكليليس دحوم

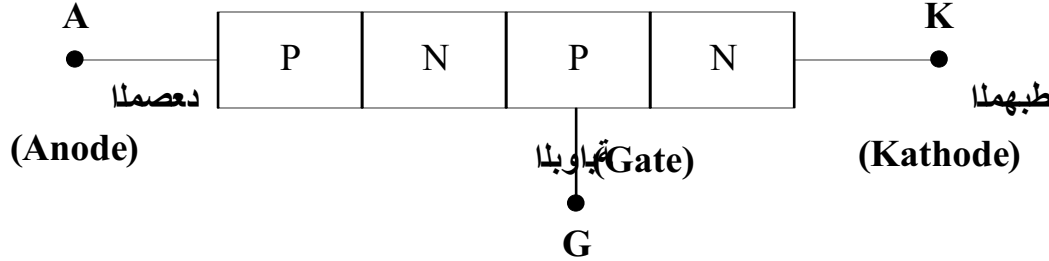
الموحد السيليكوني المحكوم (SCR) Silicon Controlled Rectifier

يعتبر الموحد السيليكوني المحكوم (SCR) أهم عائلة الثايرستور وهو عنصر **رباعي الطبقة ثنائي القطبية ثلاثي الأطراف**. ويشبه في عمله عمل ثنائي القدرة غير أنه يمكن التحكم في توصيله عن طريق طرف البوابة (الغير موجود في الثنائي)، وكذلك يختلف عن الترانزستور ثنائي القطبية كونه عنصر غير فعال أي ليس له القابلية على التكبير و فرق آخر في كونه لا يحتاج إلى فولتية بوابة بشكل مستمر كما في الترانزستور حيث يحتاج إلى فولتية القاعدة بشكل مستمر، أي أنه يمكن تسليط فولتية على البوابة وبعد ذلك قطع هذه الفولتية ويبقى في حالة توصيل مشابه لمبدأ ال Starter في النيون.

أن ال SCR هو أحد عناصر اليكترونيات القدرة وهي العناصر التي تتعامل مع الإشارة الكهربائية عالية التيار ومع الإشارة الالكترونية بنفس الوقت.

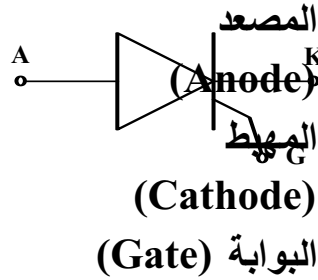
تركيب SCR ورمزه والدائرة المكافئة له

يتألف الـ SCR من أربعة طبقات كما يلي:



تركيب الـ SCR

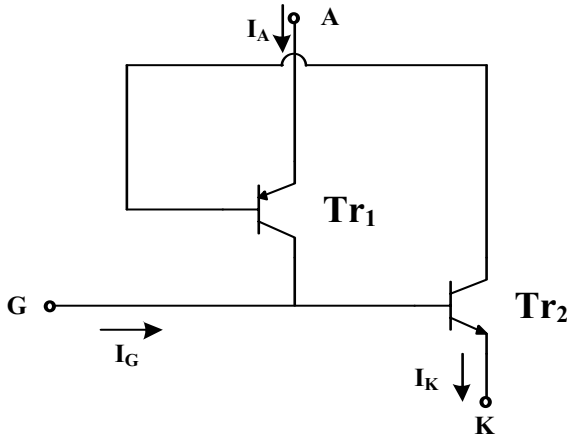
أما رمزه بالرسم فله ثلاثة أطراف كما مبين أدناه:
: طرف دخول التيار.



: طرف خروج التيار.

: طرف دخول إشارة السيطرة (فولتية القدح)

أما الدائرة المكافئة له فيمكن تمثيله بترانزستورين ثنائية القطبية أحدهما NPN والآخر PNP كما موضح



فحص SCR

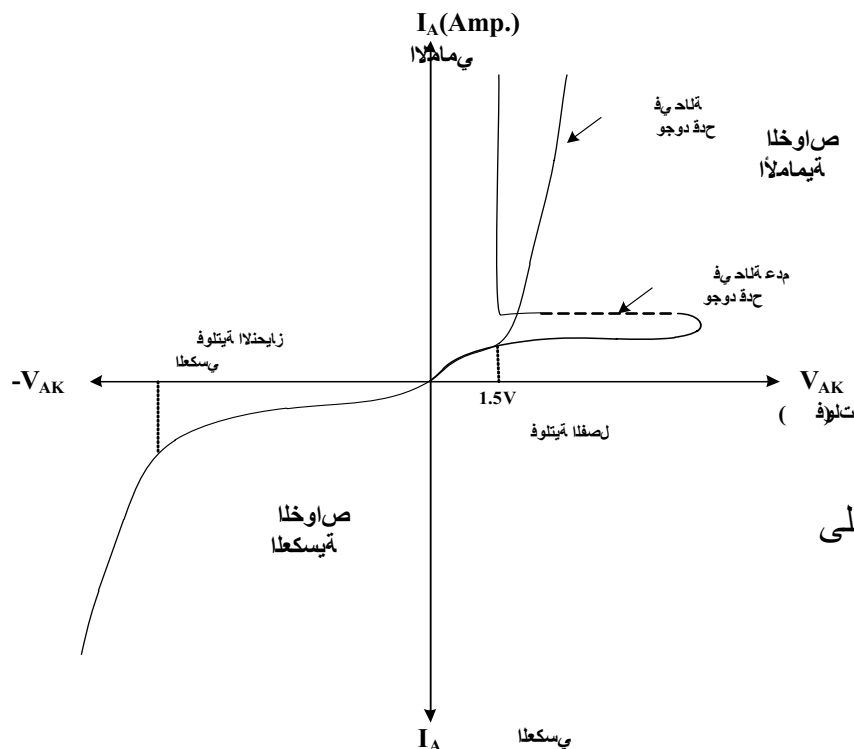
- يتم فحص الـ SCR باستخدام الافوميتر (الفحص البارد) بنفس طريقة فحص الترانزستور ثنائي القطبية أي أنها ستة فحوصات هي:
- فحصان بين A و K وتكون مقاومة عالية في الحالتين.
- فحصان بين A و G وتكون مقاومة عالية في الحالتين أيضاً.
- فحصان بين G و K وتكون مقاومة قليلة في اتجاه ومقاومة عالية في الاتجاه الآخر.

وتفيد الفحوصات أعلاه في الأمور التالية:

- تحديد هل أن الـ SCR صالح للعمل أم عاطل.
- تحديد كل طرف A، K، G.
- في بعض أنواع الـ SCR يشبه شكلها بعض أشكال الترانزستورات وتكون الفحوصات مفيدة في التمييز بينهما.

منحني خواص SCR

منحني الخواص للـ SCR عبارة عن العلاقة بين تيار المصعد I_A وفولتية المصعد إلى المهبط V_{AK} في حالتَي الانحياز الأمامي والعكسي كما هو الحال في ثنائي القدرة، كما في الشكل أدناه:



نلاحظ أن الخواص العكسية مشابهة للخواص العكسية للثنائي الاعتيادي وكذلك الخواص الأمامية عند وجود فولتية القذح على البوابة، اما عند عدم وجود القذح فإن المنحني مختلف تماماً.

نظرية اشتغال SCR

بحدود 5 فولت وعندها يكون اشتغال V_{GK} بشكل صحيح يجب تسليط فولتية قدح موجبة كافية بين البوابة والكاثود SCR لكي يعمل الـ SCR مشابه لاشتغال الثنائي حيث يكون عبارة عن مفتاح مغلق في حالة الانحياز الأمامي (عندما تكون فولتية المصعد أكبر من فولتية المهبط) وتكون فولتية الفصل بحدود (1.5 فولت) وليست 0.7 فولت أو 0.3 فولت كما في الثنائي الاعتيادي. ويكون عبارة عن مفتاح مفتوح في حالة الانحياز العكسي.

ولا يعمل الـ SCR عند عدم تسليط فولتية قدح مناسبة أي يكون عبارة عن مفتاح مفتوح.

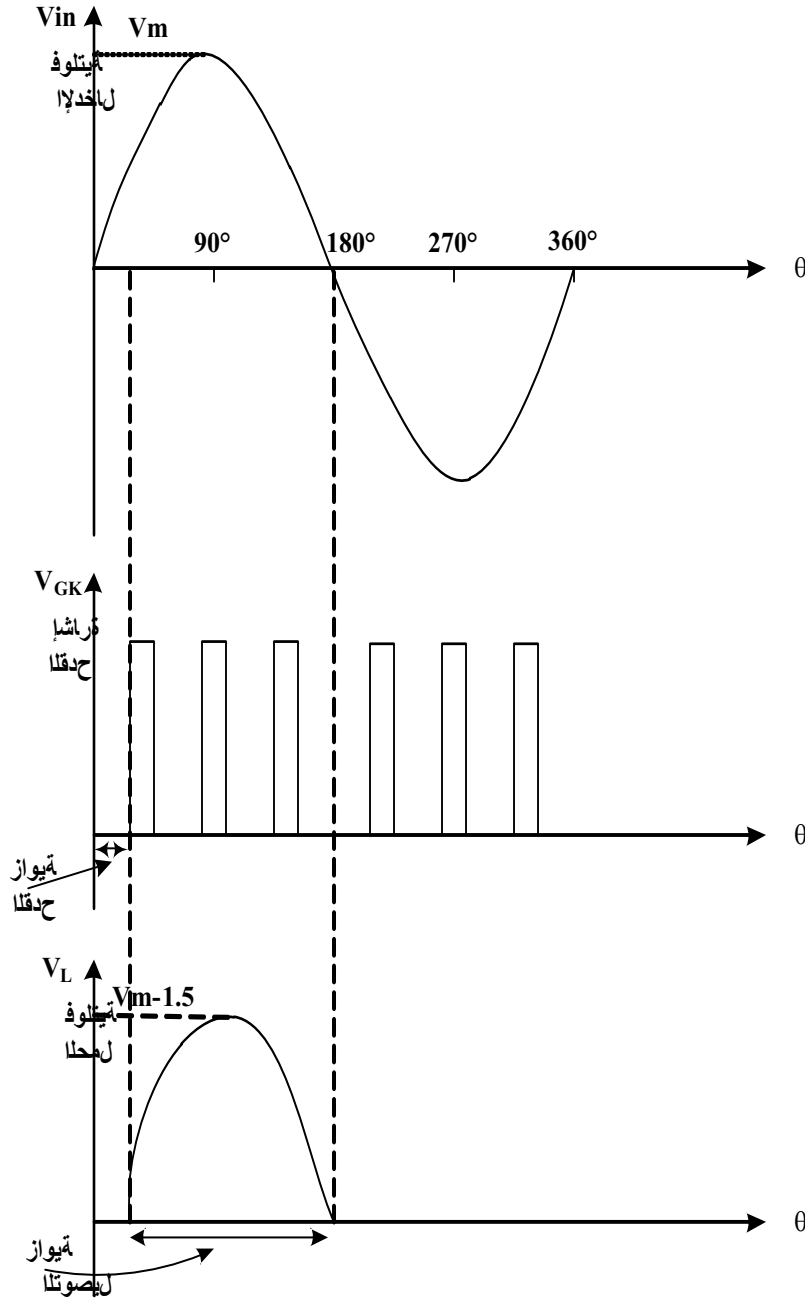
استعمالات SCR

للـ SCR استعمالات عديدة لعل من أهمها:

- تحويل الموجة المتناوبة إلى مستمرة أي تحويل A.C إلى D.C وخاصة في نظام ثلاثي الطور (3- ϕ).
- للسيطرة على سرعة المحركات واشتغال العديد من الأجهزة الصناعية والمنزلية (على سبيل المثال منظم المروحة السقفية الالكترونية).

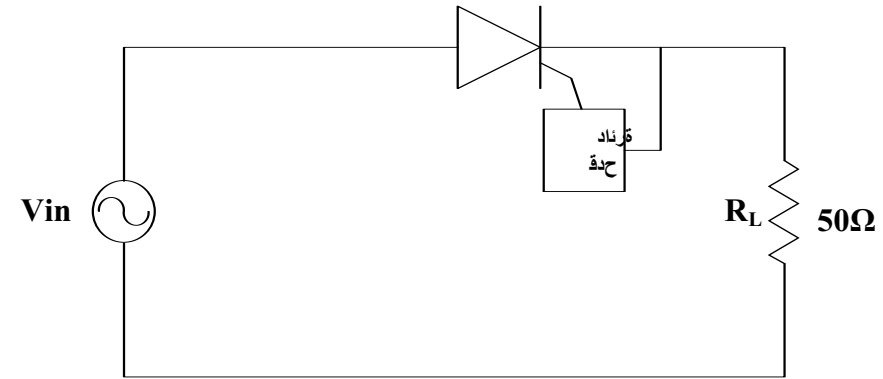
زاوية القذح وزاوية التوصيل

زاوية القذح هي الفترة الزمنية معرفة بدلالة الزاوية لأول نبضة قذح في الانحياز الأمامي عندما تكون إشارة القذح بشكل نبضات (كما موضح في الشكل المجاور) وتكون قيمة هذه الزاوية صفراً عندما تكون الفولتية المسلطة على البوابة بشكل مستمر. أما زاوية التوصيل فهي الفترة الزمنية التي يكون فيها ال SCR في حالة توصيل ومعرفة بدلالة الزاوية ويمكن حسابها من العلاقة التالية:
زاوية التوصيل = $180^\circ -$ زاوية القذح

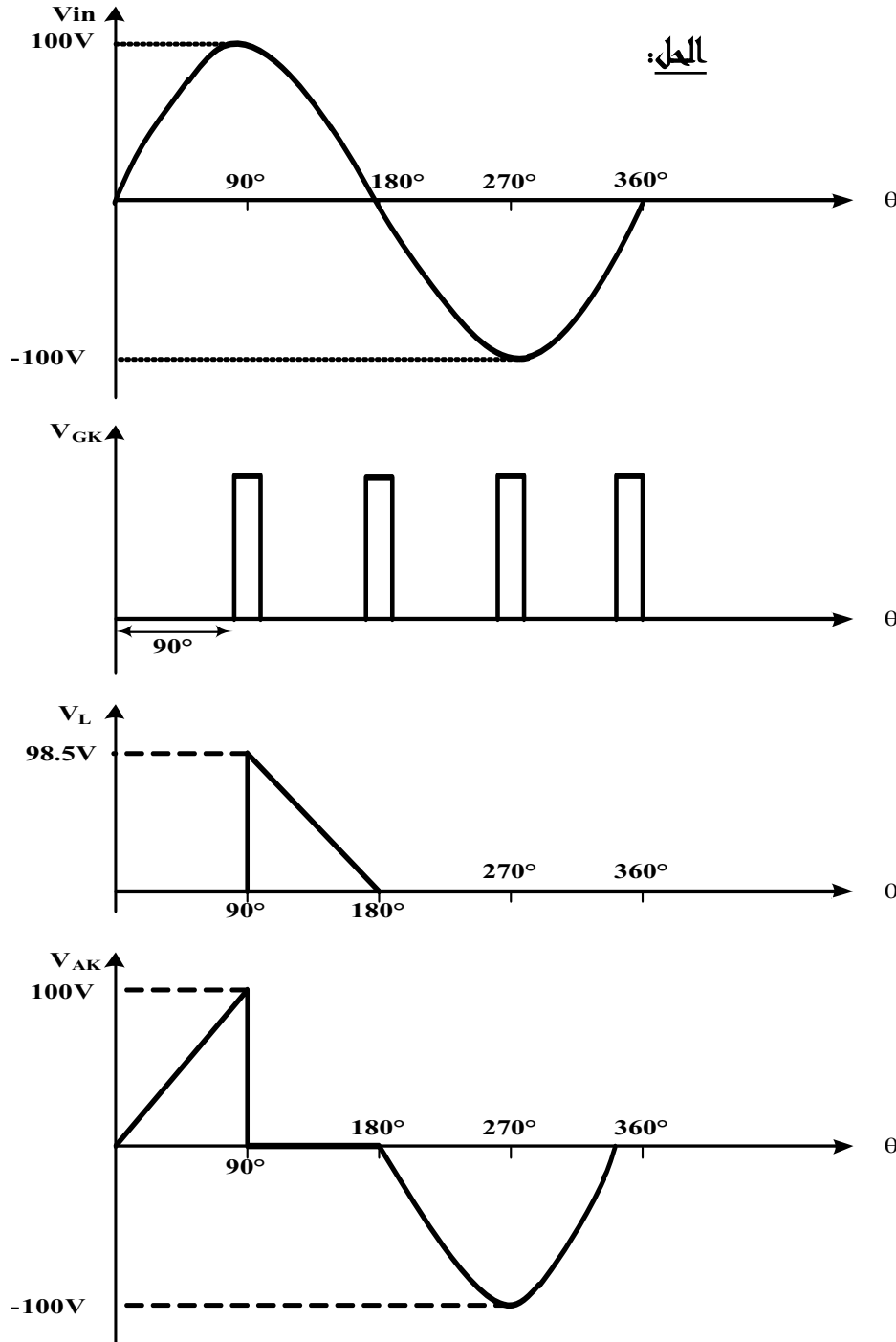


مثال:

في الدائرة المرسومة أدناه، إذا كانت زاوية القذح 90°
وفولتية الإدخال $V_{in}=100\sin 314t$.
أرسم شكل موجة الحمل والموجة على الـ SCR.

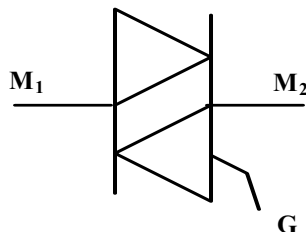


الحل:

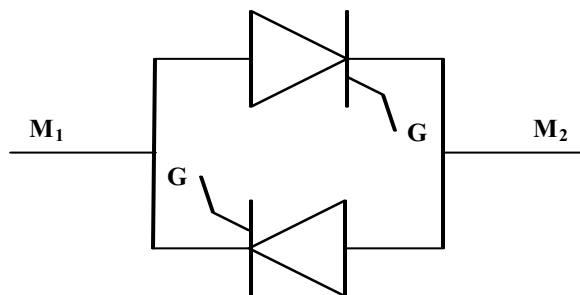


الترياك Triac

وهو عنصر آخر من عناصر اليكترونيات القدرة ومن عائلة الثايروستور.
رمزه بالرسم"



ويستخدم لإمرار نصفي الموجة المتناوبة السالب والموجب ويتحكم كونه عبارة عن اثنين من ال SCR مربوطين بشكل معكوس كما
مبين أدناه:



جدول مقارنة بين الـ SCR وثنائي القدرة

ثنائي القدرة	الـ SCR الموحد السيليكوني المحكوم
1. أحد العناصر الالكترونية.	1. أحد عناصر اليكترونيات القدرة.
2. عنصر ثنائي الطبقة.	2. عنصر رباعي الطبقة.
3. له طرفان (A, K).	3. له ثلاثة أطراف (A, K, G).
4. لا يحتاج لفولتية قدح. (لماذا؟)	4. يحتاج إلى فولتية قدح لكي يعمل.
5. يستعمل في تحويل إشارة الـ A.C إلى D.C.	5. يستعمل في تحويل إشارة الـ A.C إلى D.C.
6. يستعمل في دوائر الالزام والتقليم وغيرها.	6. يستعمل في دوائر السيطرة الصناعية والمنزلية.
7. يمر فيه تيار واحد.	7. يمر فيه تيار رئيسي واحد.

ملاحظة: بإمكان الطالب إضافة أي نقطة يراها مناسبة للمقارنة سواء تشابه أم اختلاف.

جدول مقارنة بين الثرانزستور ثنائي القطبية وال SCR

الثرانزستور ثنائي القطبية (BJT)	الموحد السيليكوني المحكوم (SCR)
1. أهم العناصر الالكترونية الفعالة.	1. أحد عناصر اليكترونيات القدرة.
2. مكون ثلاثي الطبقة.	2. مكون رباعي الطبقة.
3. له ثلاثة أطراف.	3. له ثلاثة أطراف
4. أطرافه (B, E, C)	4. أطرافه (G, K, A).
5. له ثلاثة تيارات مختلفة.	5. له تيار رئيسي واحد.
6. يحتاج لتيار قاعدة مستمر.	6. يحتاج لفولتية بوابة متقطعة.
7. له استعمالات كثيرة منها التكبير، التنظيم في الدوائر الرقمية ... الخ.	7. له استعمالات عديدة منها تحويل الإشارة المتناوبة إلى مستمرة وفي السيطرة الصناعية والمنزلية.

ملاحظة: بإمكان الطالب إضافة أي نقطة يراها مناسبة للمقارنة سواء تشابه أم اختلاف.

تصنيع الدوائر المتكاملة

مكونات الدائرة المتكاملة

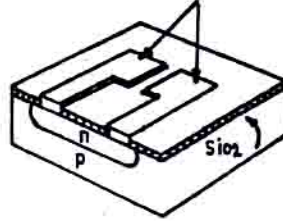
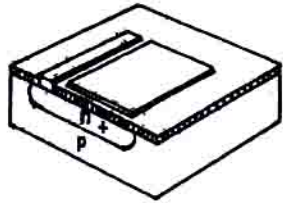
تشمل الدائرة المتكاملة على العناصر غير الفعالة (المقاومات، المتسعات والمحااثات) وكذلك العناصر الفعالة (الثنائيات والترانزستورات) وهي عناصر الدائرة الالكترونية الاعتيادية والمأوفة وتصنع جميع هذه العناصر باستخدام أشباه الموصلات.

ففي الشكل (أ) مقاومة تنتج بانتشار مادة سالبة n على طبقة سفلية موجبة p. ويغطي سطح البلورة بطبقة من اوكسيد عازلة SiO_2 لحماية السطح من التلوث ثم تنتهي بتوصيلات معدنية.

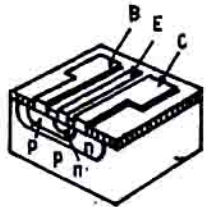
كما تصنع المتسعات بترسيب طبقة عازلة من ثاني اوكسيد السيلكون SiO_2 على طبقة موصلة وبعدئذ تشكل طبقة معدنية لتوليد الصفيحة الثانية للمتسعة كما في الشكل (ب).

ولا تختلف صناعة العناصر الفعالة عن غير الفعالة وكما هو مبين في الشكل (ج، د) غير أن المساحات التي تحتاجها المتسعة تكون أكبر من المقاومة في حين تحتاج الثنائيات والترانزستورات إلى مساحات أصغر. ويتم ربط هذه العناصر مع البعض بترسيب طبقة من موصل مثل الالمنيوم

نوصيلنا معدنية

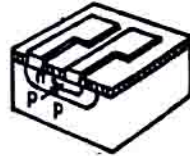


ب- متسعة



ج- ترانزستور

آ- مقاووم



د- ثنائي

وبطبيعة الحال، فإن عمليات الانتشار تتم خلال منافذ بعد تعريض السطوح المعدنية للانتشار بتقنية الطبع الضوئي ومن خلال اقنعة خاصة تصمم لكل مرحلة. وفيما يخص المحاثات، فلم يتم العثور على طرق تصنيعها بمقادير مرضية نسبياً وتغطي الفقرات التالية تفصيلاً أوسع في تصنيع الدوائر المتكاملة

تصنيع الترانزستور المستوى Planar Transistor Fabrication

بعد التعرف على مكونات الدائرة المتكاملة، يمكن استعراض الخطوات المتبعة في صناعة الترانزستور المستوي نوع NPN وكما يلي:

الخطوة الأولى - تصنيع الجامع

- تحضر شريحة سالبة n كما في الشكل (أ) ويصقل أحد السطحين لتخليصه من العيوب وتستعمل هذه الشريحة كطبقة سفلية Substrate لاسناد بقية أجزاء الترانزستور وفي نفس الوقت تمثل الجامع.
- يغطي سطح الجامع بطبقة من ثاني أكسيد السيليكون SiO_2 العازلة لمنعه من التلوث، ويجري ذلك عن طريق نفخ السطح بغاز الاوكسجين النقي وكما هو مبين بالشكل (ب).

الخطوة الثانية - انتشار القاعدة

• يطلى سطح الاوكسيد SiO_2 بغشاء رقيق من مادة المضاد الضوئي Photoresist.

- يعرض المضاد الضوئي إلى أشعة فوق البنفسجية خلال قناع ضوئي لفتح منفذ (نافذة) نحو وسط البلورة (طبقة الجامع) بعد حفره بالحامض.
- توضع الشريحة في فرن وتعرض إلى ذرات شوائب ثلاثية التكافؤ فتتولد قاعدة الترانزستور الموجبة P وحسب ما يوضحه الشكل (ج).
- يعاد تعريض السطح إلى الاوكسجين لبناء الطبقة الاوكسيدية العازلة وتوضح في الشكل (د).

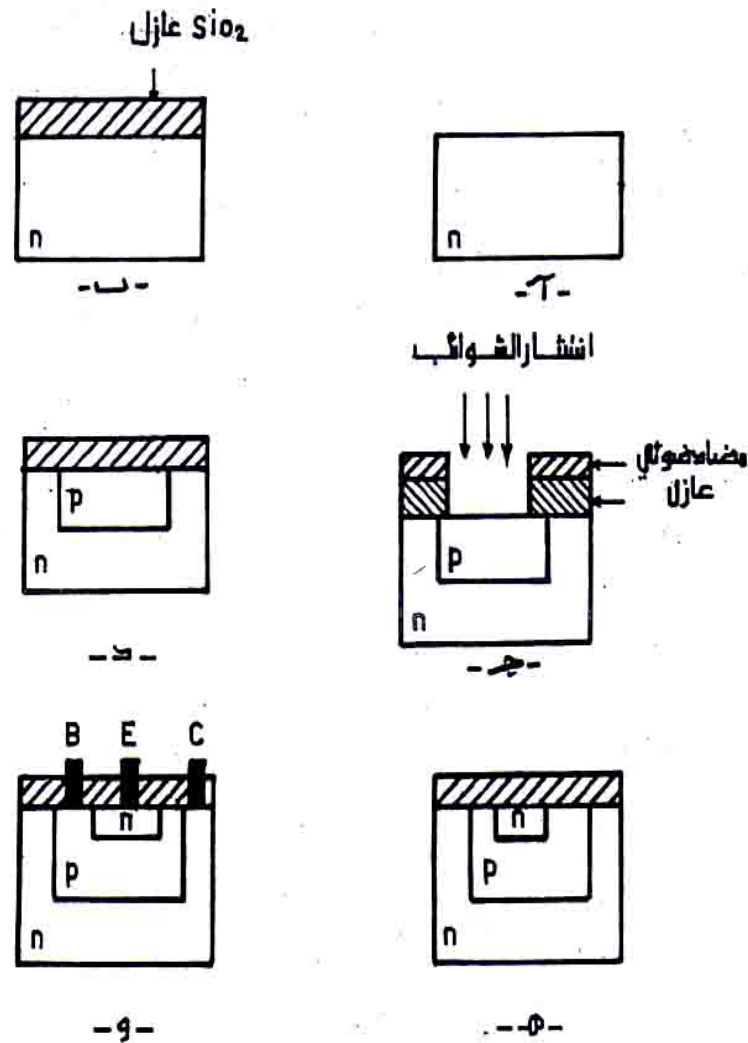
الخطوة الثالثة - انتشار الباعث

- يعاد طلي الطبقة الاوكسيدية بطبقة جديدة من مادة المضاد الضوئي ثم تعرض إلى الضوء خلال قناع آخر لفتح منفذ جديد.
- تمرر ذرات شوائب خماسية التكافؤ خلال النافذة مما تترسب طبقة الباعص.
- يغطي السطح بطبقة الاوكسيد العازلة مرة أخرى كما مبين بالشكل (ه).

الخطوة الرابعة - المعدنة بالالمنيوم

- لأجل تكوين توصيلات اقطاب الترانزستور تستخدم اغشية معدنية ذات مقاومات واطئة، ويعد الالمنيوم وسبائكه من أكثر المعادن شيوعاً في الدوائر المتكاملة والمنفصلة على السواء. إضافة إلى ان الالمنيوم يلتصق جيداً مع ثاني أكسيد السيليكون، وتدعى عملية ترسيب غشاء رقيق من الالمنيوم على طبقات الترانزستور بالمعدنة metallization. ولتحقيق ذلك، يطلى السطح كلياً بغشاء رقيق من الالمنيوم ثم تفتح منافذ لإزالة المعدن من جميع المساحات غير المطلوبة باستعمال طبقة جديدة من المضاد الضوئي ويتم الاقطاب الثلاث للترانزستور بالالمنيوم كما يظهر في الشكل (و).

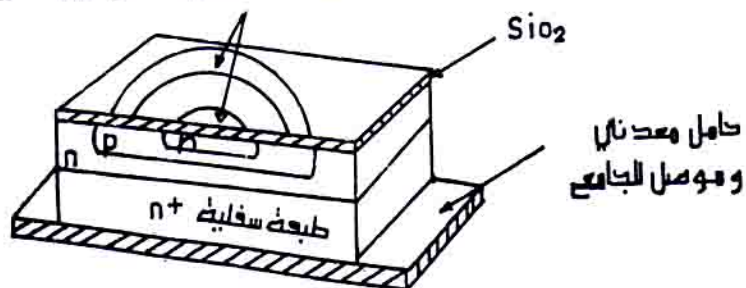
شكل يبين خطوات تصنيع الترانزستور المستوي



وعلى الطالب أن يقدر بأن ما سبق شرحه هو شرح مبسط للعمليات المتبعة لأنه في الواقع تتطلب صناعة الدائرة المتكاملة إلى حوالي 80 إلى 100 عملية منفصلة، تحتاج بعضها إلى بضع ساعات أو أكثر لإنتاجها.

ولما كانت المساحة المكشوفة للانتشار باستخدام قناع في الترانزستور المستوي هي نفسها لكل ترانزستور ضمن الشريحة الواحدة، لذلك يمكن تعريض شريحة السيلكون كلياً في نفس الوقت لعمليات الانتشار مما يؤدي إلى صناعة ما يصل عشرة آلاف ترانزستور على شريحة بقطر سنتيمتر واحد وخلال مرحلة تصنيع واحدة. ومن الجدير بالذكر ، أن صناعة الترانزستور (هنا npn) تعد أساساً في الدائرة المنفصلة أو المتكاملة، غير أن سمك الطبقة السفلية لهذا الترانزستور يزيد من مقاومة الجامع ويعيق استجابة الترانزستور لحالات الاقلاب (الفتح والغلق) وللتغلب على هذه الاعاقة، طورت تقنية الترانزستور المستوي إلى نوع آخر يدعى بالنمو (الترتيب) الفوقي Epitaxial. ولكن لا يختلف النوعين من حيث المبدأ باستثناء أن الجامع يتركب من طبقتين مرتبتين الواحدة فوق الأخرى. وتصنع الطبقة الفوقية بسمك قليل جداً وذات مقاومة عالية. وهكذا تغلبت تقنية النمو الفوقي على غيرها في صناعة الدوائر المتكاملة والشكل الموضح يسن نموذج آخر لتوضيح الطبقة الفوقية وتدل الإشارة الموجبة التي ترافق الحرف n، على أن منسوب التطعيم يزيد على، المنسوب المستخدم مع بقية الحروف.

نوصيلاً بعد ذلك لكل من B , E



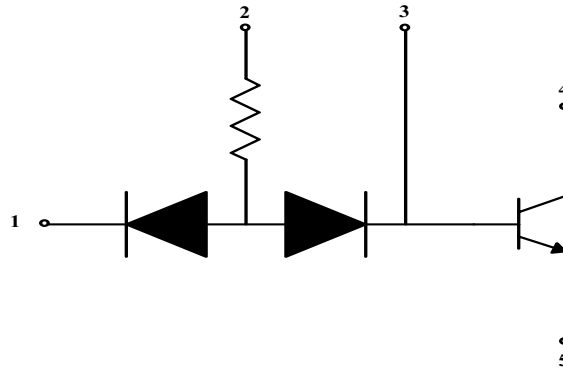
ترانزستور مستوي ذو الترتيب الفوقي

الدوائر المتكاملة احادية (البلورة) القطعة Monolithic Integrated circuit

أن اللفظ اللاتيني (Monolithic) الذي يطلق على هذه الدوائر مشتقة من الكلمة اليونانية Monos معناها احادي أو مفرد وكلمة Lithos تعني حجر وهكذا فامعنى العام يصبح احادي الطبقة أو القطعة. ومن هنا يتضح أن العناصر الفعالة وغير الفعالة تصنع وتجمع على رقاقة (شريحة) أو طبقة سفلية (شاصي) Substrate واحدة من السيلكون وعليه يمكن اعتبار المصطلح مناسباً لأن المكونات جزء من رقاقة واحدة. وتعد طريقة صناعة الدوائر المتكاملة بهذه التقنية أكثر شيوعاً، حيث تم صناعة دوائر متكاملة تعمل بكفاءة جيدة عند الترددات العالية. كما تم صناعة دائرة متكاملة تجارياً بحيث تحوي في حدود 500000 ترانزستور بهذه الصيغة. لأجل فهم صناعة دائرة متكاملة احادية القطعة يفضل الاستعانة بمثال.

مثال:

ارسم مقطعاً عرضياً للدائرة المتكاملة بتقنية احادية القطعة للدائرة الالكترونية المبينة بالشكل أدناه، ثم وضع خطوات تصنيع الدائرة المتكاملة.

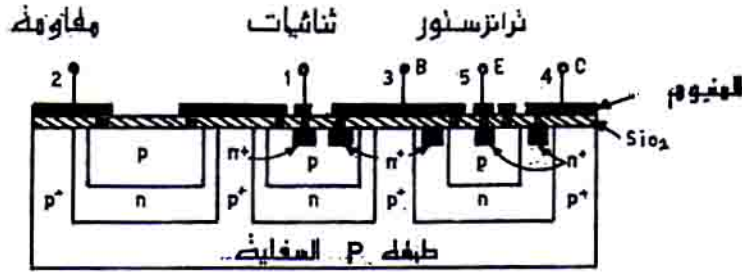


الدائرة الالكترونية

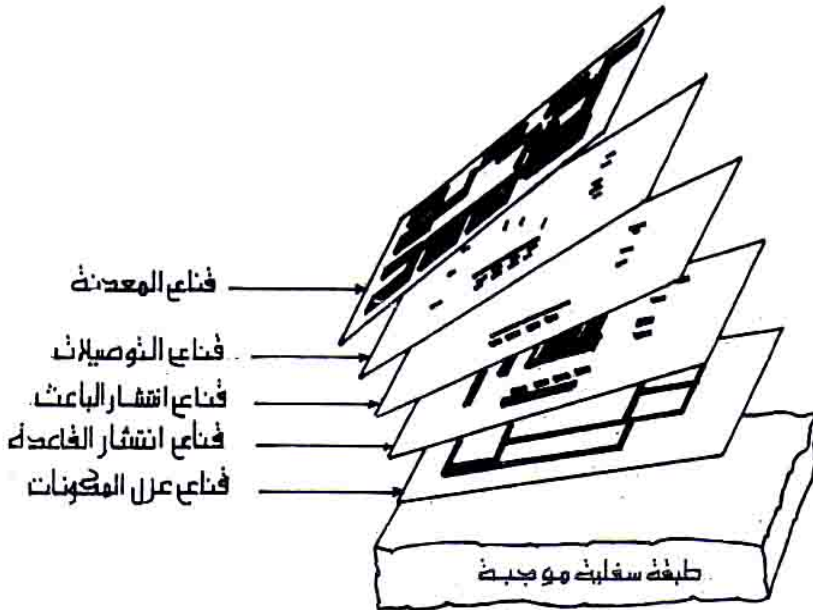
الحل:

يوضح الشكل أدناه المقطع العرضي للدائرة الالكترونية المبينة في الشكل اعلاه. تطبق الخطوات المبينة في الفقرة السابقة لتصنيع هذه الدائرة المتكاملة. إلا أن صناعة كل دائرة متكاملة تمرر خلال العمليات الدقيقة التالية:

1. Epitaxy نمو الترتيب الفوقي
2. Diffusion الانتشار
3. Oxidation الاكسدة
4. Deposition & Metallization الترسيب والمعدنة



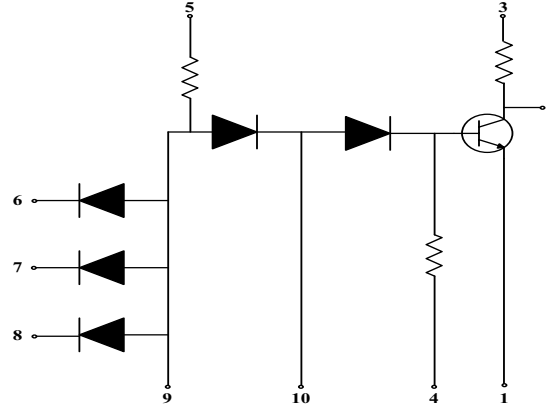
ولكل مرحلة اقنعة خاصة بها وقد تعاد المراحل والاقنعة أكثر من مرة وحسب خطوة التصنيع، وتستخدم في ذلك أجهزة تكبير وتصغير وتصوير (ميكروسكوبات وكاميرات) لغرض التحكم الدقيق في مراحل التصنيع والشكل أدناه يوضح نموذج لمصفوفة أقنعة.



مصفوفة تعاقب الاقنعة

مثال:

أرسم رقاقة سليكونية ثم حدد سطحها المساحات المناسبة للدائرة الالكترونية المبينة في الشكل أدناه بتقنية الدوائر المتكاملة احادية القطعة.



الحل:

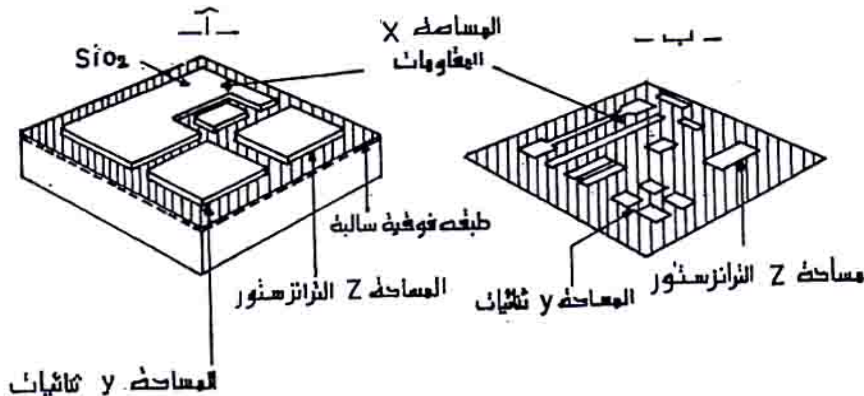
يتبين من دائرة الشكل أعلاه وجود ترانزستور واحد، ثلاث مقاومات وست ثنائيات ولأجل تحديد المساحات اللازمة لمكونات هذه الدائرة، يمكن تحضير قناع لعزل المكونات بصورة مجمعة وكما يتضح من الشكل (أ)، ثم مناقشة مساحة كل عنصر بشكل مفصل وكالاتي:

المساحة X للمقاومات الثلاث، بحيث تأخذ مساحات متجاورة ومستطيلة، وتصنع بانتشار مادة موجبة في ماجدة سالبة وبنفس التقنية

التبعة في الفقرات السابقة.

المساحة Y لأربع ثنائيات في جانب واحد لأنها ذات مصاعد مشتركة، في حين يوضع الثنائيين الآخرين في مساحة منفصلة وقريبة من الترانزستور.

المساحة Z للترانزستور، وتكون أكبر من مساحة الثنائي الواحد بسبب طبقة الجامع العريضة والتوصيلات الخاصة به ولبقية اقطاب الترانزستور. وتظهر المساحة منفصلة في الشكل (ب).



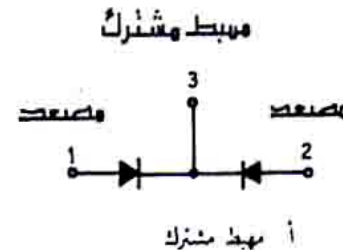
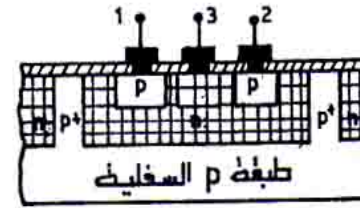
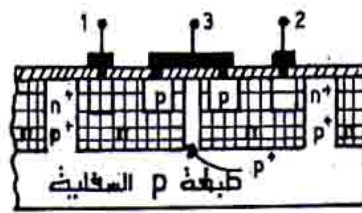
مخطط المساحات اللازمة للمثال السابق

الترانزستورات المتكاملة

لا يختلف الترانزستور المستوي في صناعته عن ترانزستورات الدوائر المتكاملة احادية القطعة، ولكن في الدوائر المتكاملة يتم عزل الجامع عن الطبقة السفلية بواسطة توفير انحياز عكسي للثنائيات والمتولدة من الجزر الشكل (ا). غير أن هذا الأسلوب قد ينتج بعض المتاعب، لأن هذه الثنائيات تغطي أرضية الرقاقة بالكامل مما تولد وتضيف متسعاً خيالية إلى قطب الجامع وتزيد من مسار تيار التسرب وطول مسار تيار الجامع مولداً ارتفاعاً في مقاومة الجامع وفولتية التشبع. إلا أن هذه التأثيرات يتغلب عليها في دوائر القطعة الواحدة، لأن جميع الترانزستورات تكون متقاربة عن بعضها مما يحقق التوافق بنسبة كبيرة بين خصائصها.

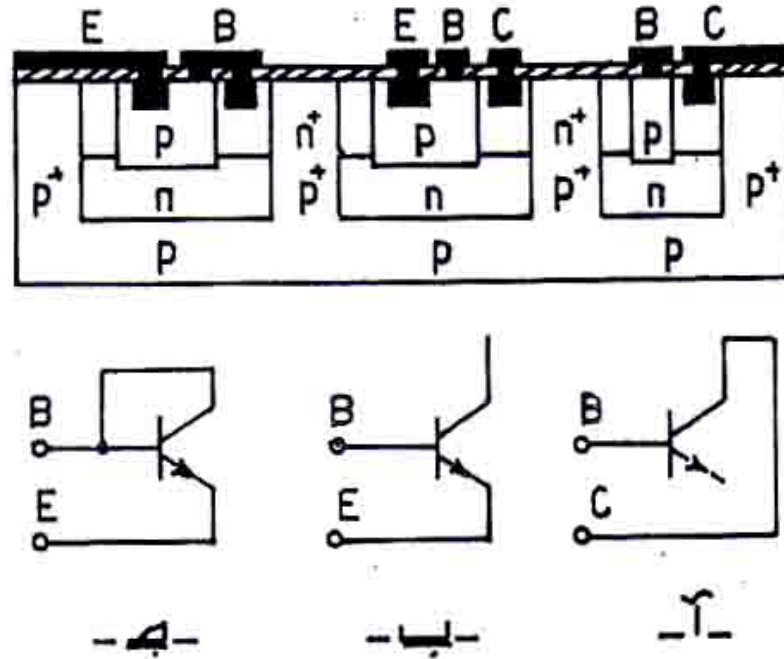
الثنائيات المتكاملة

تصنع ثنائيات الدوائر المتكاملة بنفس قننية صناعة الترانزستورات. وتوجد خمس طرائق لربط هذه الثنائيات، ولكن اختيار طريقة الربط يعتمد بالدرجة الأولى على نوع الأداء المطلوب أو الغرض من الثنائي. فعندما تقتضي الحاجة إلى فولتية انهيار أكثر من 12 فولت، تكون الثنائيات المتولدة من وصلة (مفرق) الجامع - قاعدة أكثر انهيار ملائمة، وفي هذه الحالة ترصف الثنائيات على هيئة المهبط المشترك كما في الشكل (أ)، وتصنع بانتشار طبقة عازلة مفردة (جزرة مفردة). ويمكن تحقيق نفس الهدف ولكن بجزر مزدوجة، حيث يعزل كل ثنائي عن الآخر ويعاد توصيلهما في مرحلة المعدنة وبطريقة المصعد المشترك والشكل (ب) يبين ذلك.



الثنائيات المتكاملة

ومع هذا، تصنع الثنائيات بشكل مفرد ويعزل كل واحد عن الآخر. كما يظهر في الشكل أدناه.



الثنائيات المتكاملة المستقلة

